

# 2026年3月期第3四半期(2025年4月～12月) 決算説明資料

2026年2月12日

株式会社 KOKUSAI ELECTRIC

# 注意事項

本資料及び本資料にて提供される情報は企業情報等の提供のために作成されたものであり、国内外を問わず、当社の発行する株式その他有価証券の勧誘を構成するものではありません。

## ■ 将来見通しについて

本資料に記述されている当社グループの事業計画、将来予測などは、当社グループが作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、将来の結果や業績を保証するものではありません。さまざまな外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果は計画、予測と大きく異なる結果となる可能性があります。当社グループは、適用ある法令または証券取引所の規則により要求される場合を除き、本資料に含まれるいかなる情報についても、今後生じる事象に基づき更新または改訂する義務を負うものではありません。なお、当社グループの経営成績、財政状態、キャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があるとは認識している主なリスクは、有価証券報告書に記載しております。

## ■ 為替リスクについて

当社グループにおける海外売上収益は高い水準で推移しております。また、当社グループの外貨建ての資産および負債の評価は為替相場の変動により影響を受けます。当社グループ製品の輸出売上は、ほとんどが円建てで行われておりますが、一部に外貨建売上および費用計上もあり、為替相場の変動により影響を受けることがあります。

## ■ 経営指標について

当社グループは、企業価値の向上に向けて経営成績の推移を把握するため、調整後営業利益、調整後当期(四半期)利益を重要な経営指標として位置付けております。調整の内容につきましては、決算短信に記載しております。調整後営業利益、調整後当期(四半期)利益につきましては、同様または類似の名称を用いている他社の経営指標と内容が異なる場合があります、比較可能性がない場合があります。

## ■ 会計基準について

当社グループは2021年3月期より国際会計基準(IFRS)に基づいて連結財務諸表を作成しております。

## ■ 数字の処理について

本資料に記載された金額(一部を除く)は、億円未満を四捨五入しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。



## 2026年3月期第3四半期連結決算概要

## 2026年3月期第3四半期連結決算概要

- 半導体デバイス市場は、生成AI用途の高性能Logic、DRAMを中心に世代交代・生産規模拡大投資が高水準で推移。NANDは世代交代投資が中心。民生電子機器向けや自動車・産業機器向けの需要回復は緩やか。
- 当社3Qは、2Q決算発表時に修正した業績予想に沿って推移。世界各国DRAM向けアップグレード改造を中心にサービス売上が伸長したものの、中国地場DRAM向け装置販売等の減少により減収減益。

## 2026年3月期連結業績予想と今後の見通し

- 当社26/3期は、2Q決算発表時に修正した業績予想に沿って推移しており、業績・配当予想に変更なし。
- 世界各国メーカーでは、高性能デバイスの世代交代や生産規模拡大に向けた設備投資がさらに増加する見通し。中国地場メーカーでは、大手メーカーを中心に設備投資が増加に転じる見通し。当社では27/3期に向けて装置販売、アップグレード改造の引き合いが増加基調。

# 連結業績サマリー

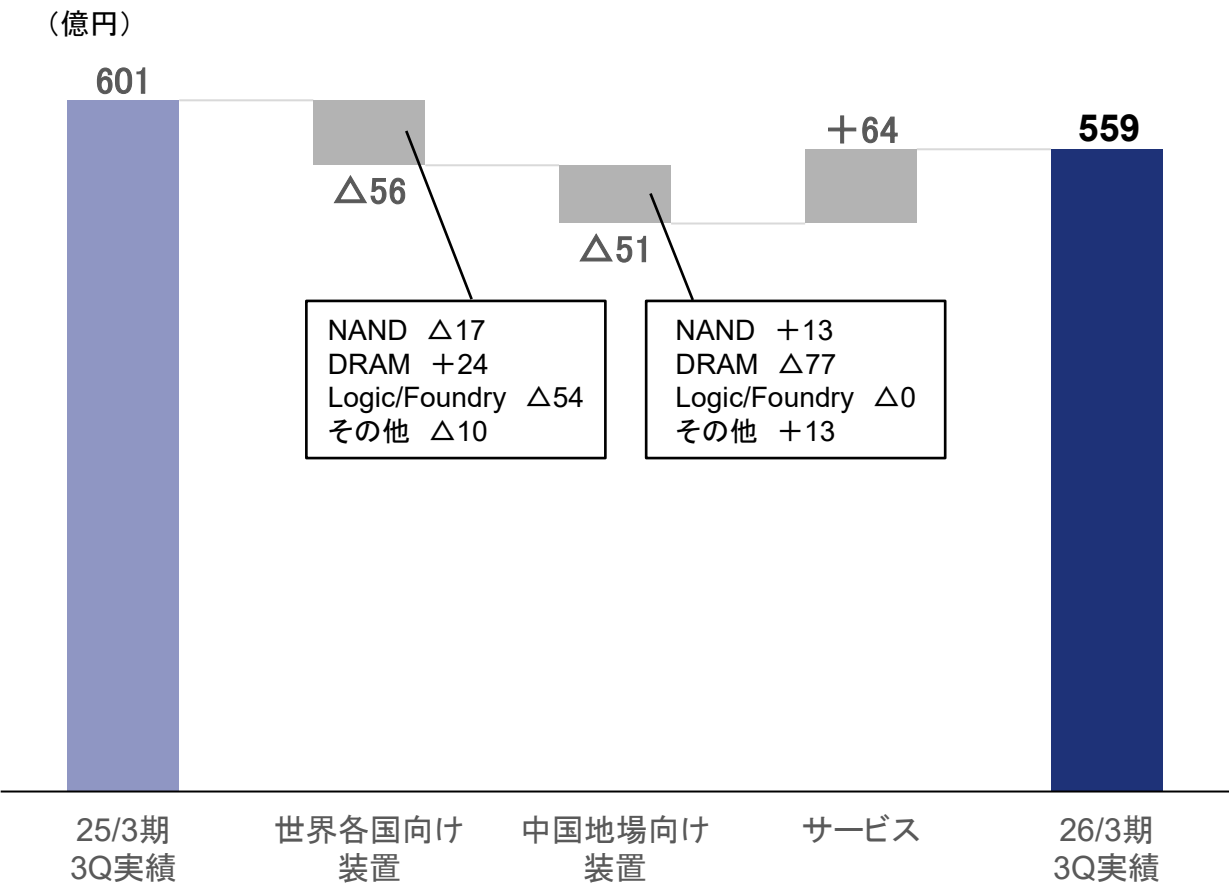
3Qは、前年同期比・直前四半期比で減収減益ながら、2Q決算発表時に修正した業績予想に沿って推移。  
3Q累計では、前年同期比で微減収。各利益は製品構成の変化や将来に向けた先行投資の影響により  
前年同期比で減少。

(億円)	25/3期				26/3期						
	1Q	2Q	3Q	3Q累計	1Q	2Q	3Q	前年同期比	前四半期比	3Q累計	前年同期比
売上収益	652	493	601	1,747	518	654	559	△7.1%	△14.6%	1,731	△0.9%
売上総利益	294	220	249	762	222	273	229	△8.0%	△16.1%	724	△5.1%
売上総利益率	45.0%	44.6%	41.4%	43.6%	42.9%	41.7%	41.0%	△0.4pts	△0.7pts	41.8%	△1.8pts
調整後営業利益	194	113	139	446	109	144	113	△18.6%	△21.8%	366	△17.8%
調整後営業利益率	29.7%	22.9%	23.1%	25.5%	21.1%	22.1%	20.2%	△2.9pts	△1.9pts	21.2%	△4.3pts
調整後当期(四半期)利益	143	73	96	313	76	98	83	△14.0%	△15.3%	257	△17.8%
調整後当期(四半期)利益率	22.0%	14.7%	16.0%	17.9%	14.7%	15.0%	14.8%	△1.2pts	△0.1pts	14.8%	△3.1pts
営業利益	179	96	123	397	97	130	98	△20.1%	△24.5%	325	△18.1%
営業利益率	27.4%	19.4%	20.4%	22.7%	18.8%	19.9%	17.6%	△2.8pts	△2.3pts	18.8%	△3.9pts
税引前当期(四半期)利益	177	102	112	392	93	128	94	△16.3%	△26.7%	316	△19.4%
税引前当期(四半期)利益率	27.2%	20.7%	18.7%	22.4%	18.0%	19.6%	16.9%	△1.8pts	△2.8pts	18.2%	△4.2pts
当期(四半期)利益	133	48	80	261	68	88	73	△9.2%	△17.3%	228	△12.4%
当期(四半期)利益率	20.4%	9.6%	13.3%	14.9%	13.1%	13.4%	13.0%	△0.3pts	△0.4pts	13.2%	△1.7pts
研究開発費	33	39	38	110	39	48	42	+10.8%	△13.7%	128	+16.4%
設備投資額	112	30	25	167	23	52	40	+61.0%	△22.9%	115	△31.1%
減価償却費	29	30	33	93	34	35	36	+9.0%	+3.7%	105	+13.8%
1株当たり配当金(円)	-	18	-	18	-	18	-	-	-	18	±0%

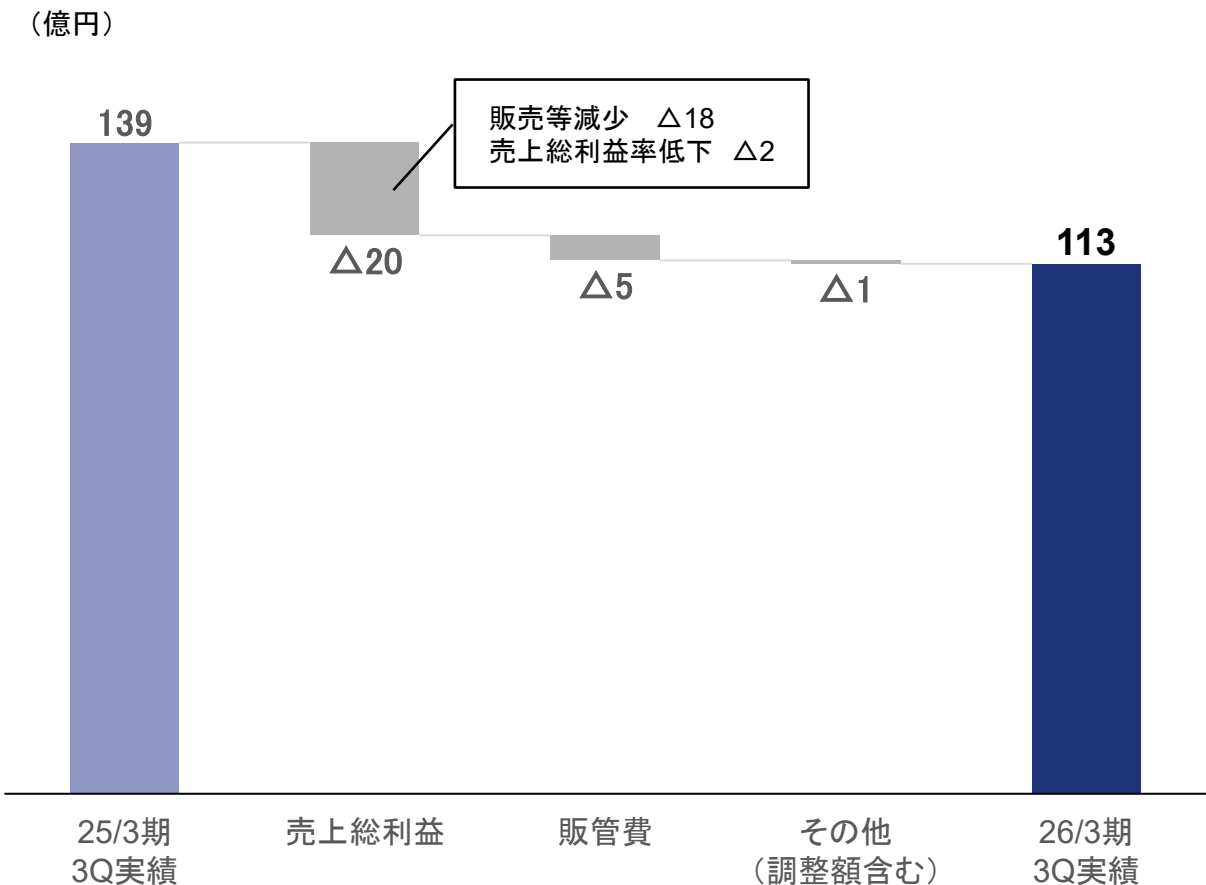
# 2026年3月期第3四半期実績 増減要因

3Qは、DRAM向けアップグレード改造（サービス）が増加した一方で、中国地場DRAM向け装置販売等が減少したため、全体の売上収益は前年同期比7%減。  
主に販売等の減少による売上総利益の減少により調整後営業利益は前年同期比19%減。

売上収益



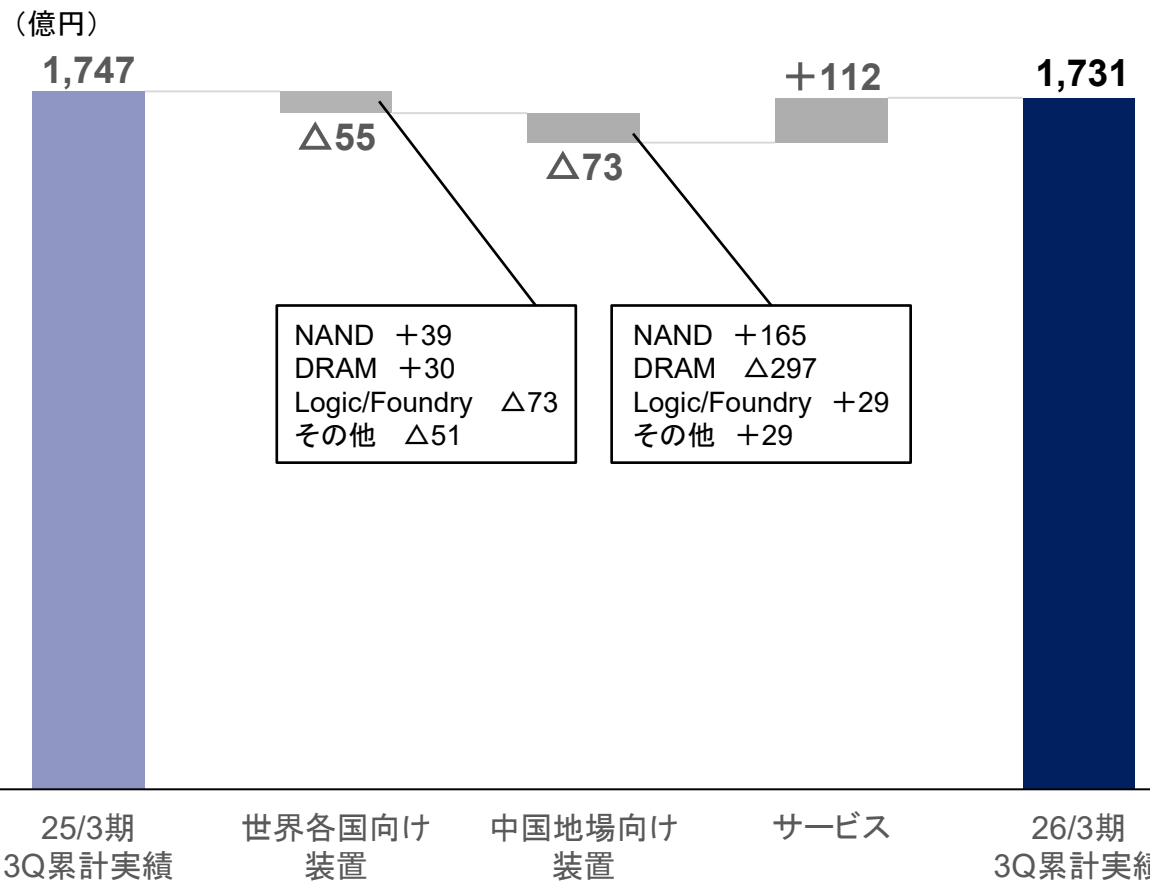
調整後営業利益



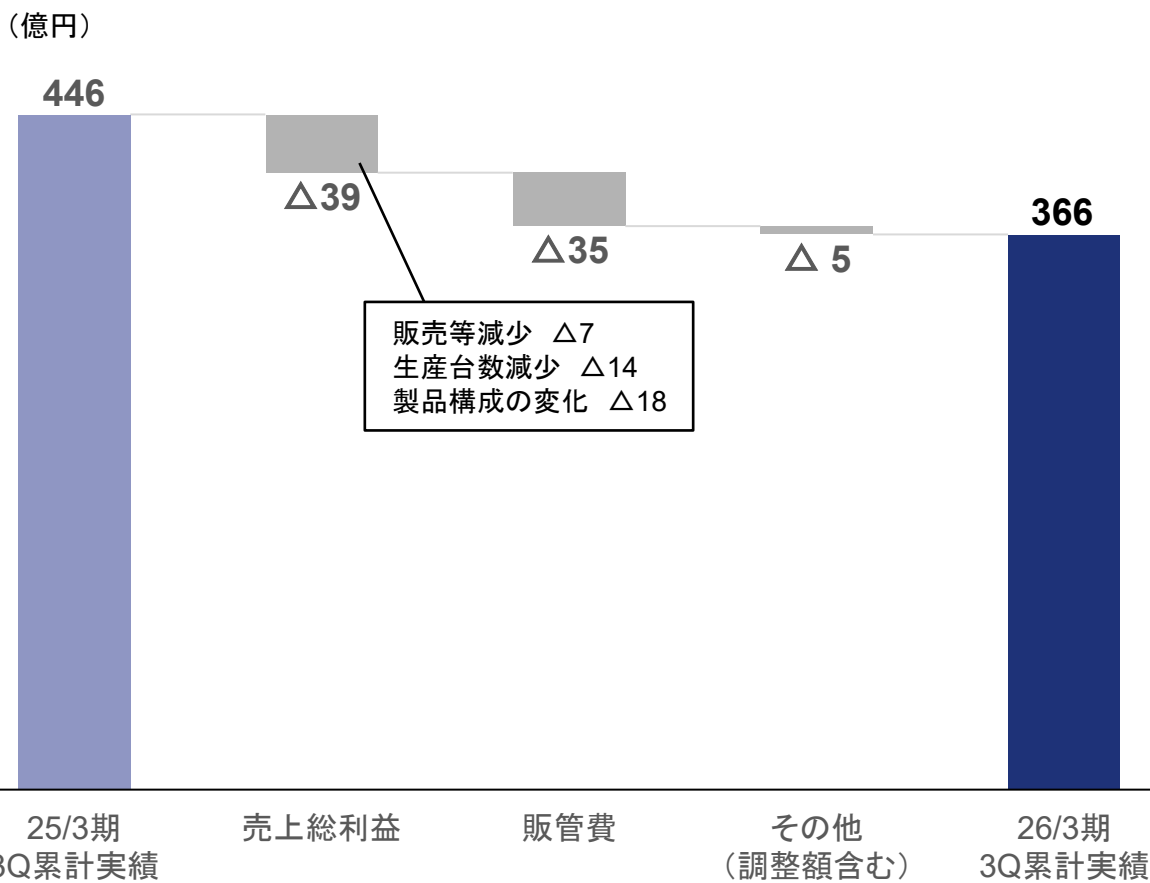
# 2026年3月期第3四半期(累計)実績 増減要因

3Q累計では、DRAM向けアップグレード改造(サービス)に加え、NAND向け装置販売が増加した一方で、中国地場DRAM向け装置販売等の減少により、全体の売上収益は前年同期比1%減。  
主に製品構成の変化による売上総利益の減少、販管費の増加により、調整後営業利益は前年同期比18%減。

売上収益

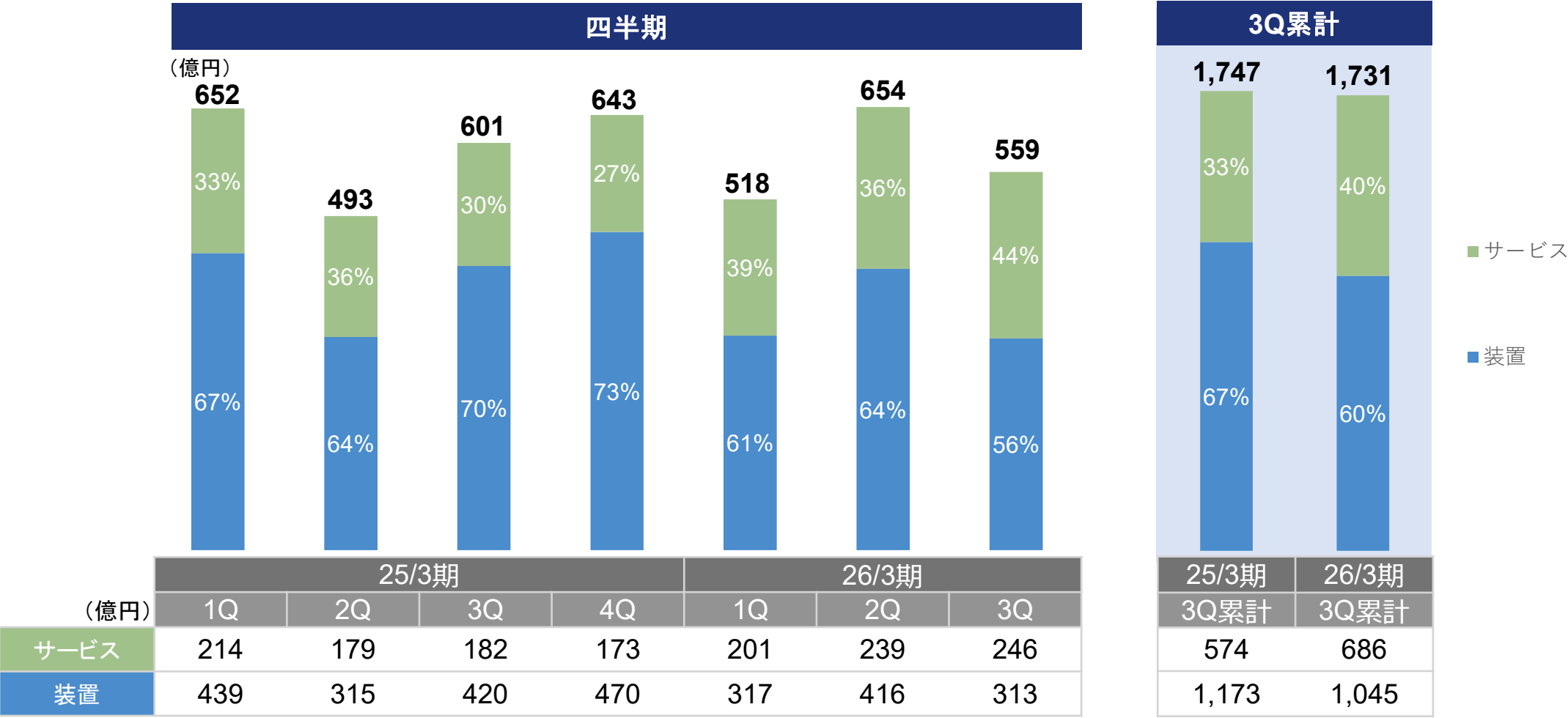


調整後営業利益



# 四半期別売上収益 ビジネス別

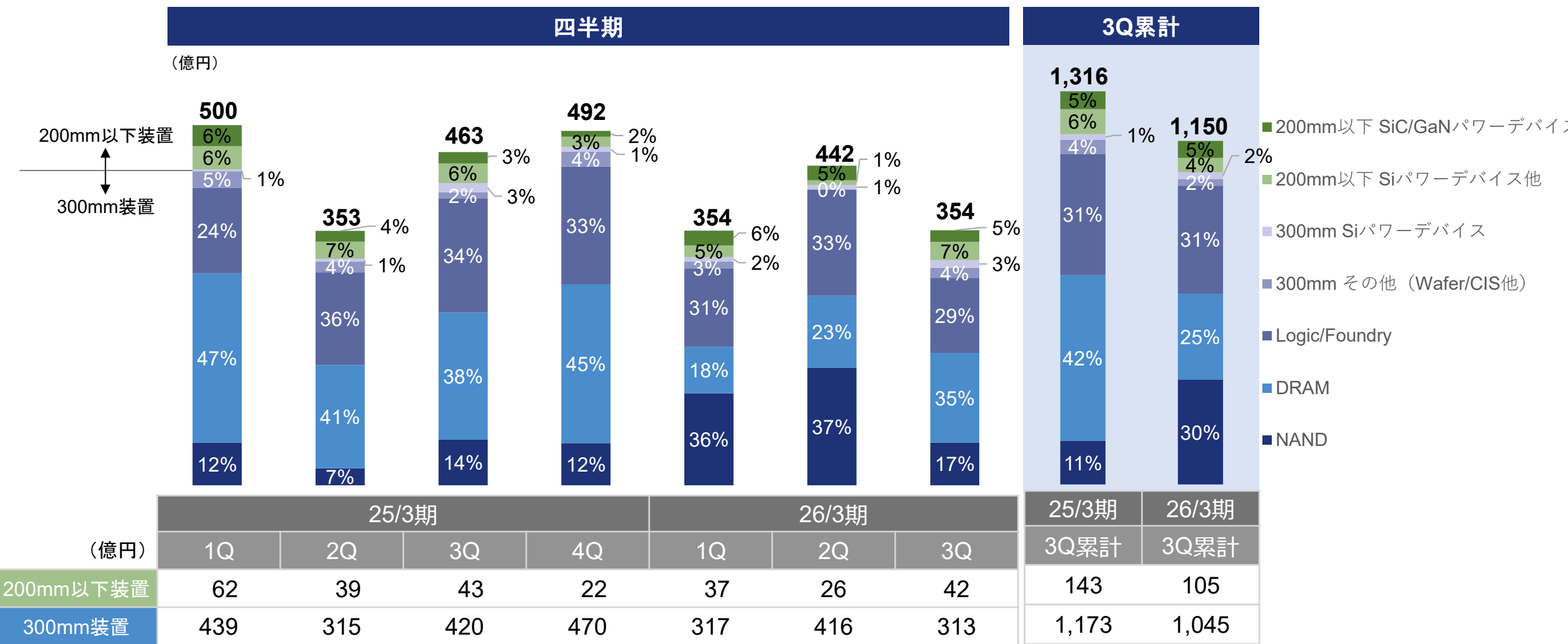
3Qは、1Q、2Qに引き続き、装置需要の一部がアップグレード改造（サービス）に置き換わり、前年同期比・直前四半期ともに装置売上が減少、サービス売上が増加。  
3Q累計でも同様の傾向で、サービス売上比率が40%に増加。





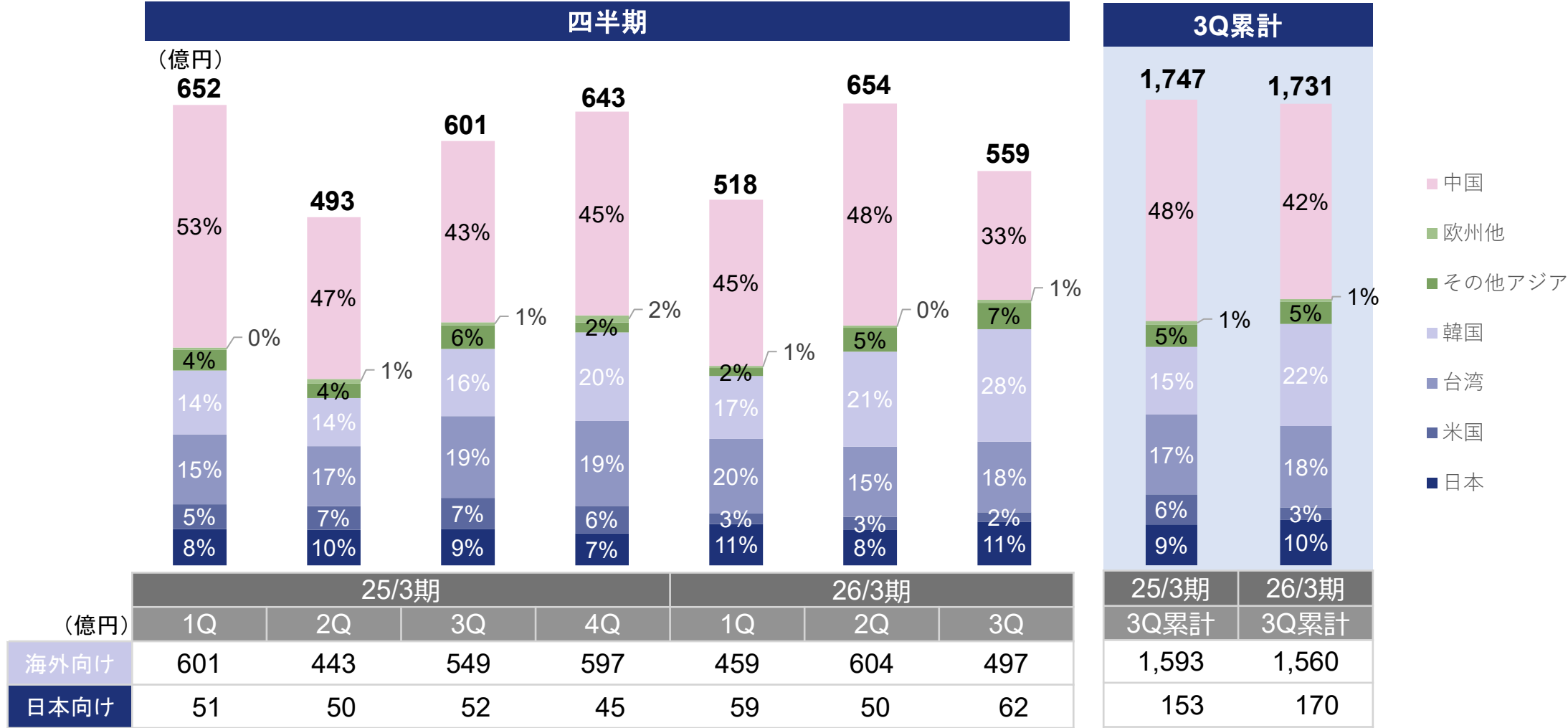
# 四半期別売上収益 アプリケーション別 (300mm装置+200mm以下装置)

3Qは、前年同期比で主要アプリケーション向け装置販売が減少も、直前四半期比ではDRAM向けが増加。  
3Q累計では、前年同期比でNAND向けが140%増、DRAM向けは48%減、Logic/Foundry向けは11%減。



# 四半期別売上収益 仕向地別

3Q、3Q累計とも、前年同期比で日本向け、韓国向けが増加。米国向け、中国向けは減少。  
米国向け売上比率は3Q累計で3%、中国向け売上比率は42%に低下。

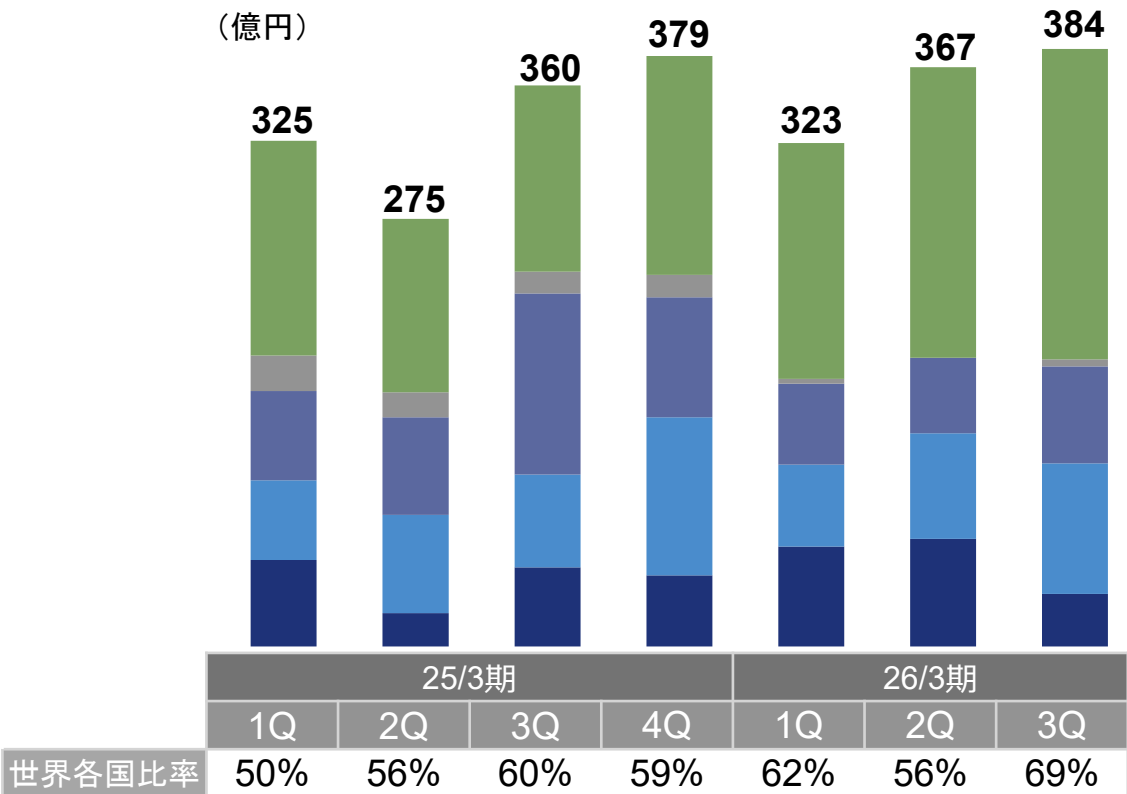


# 四半期別売上収益 アカウント別\*1

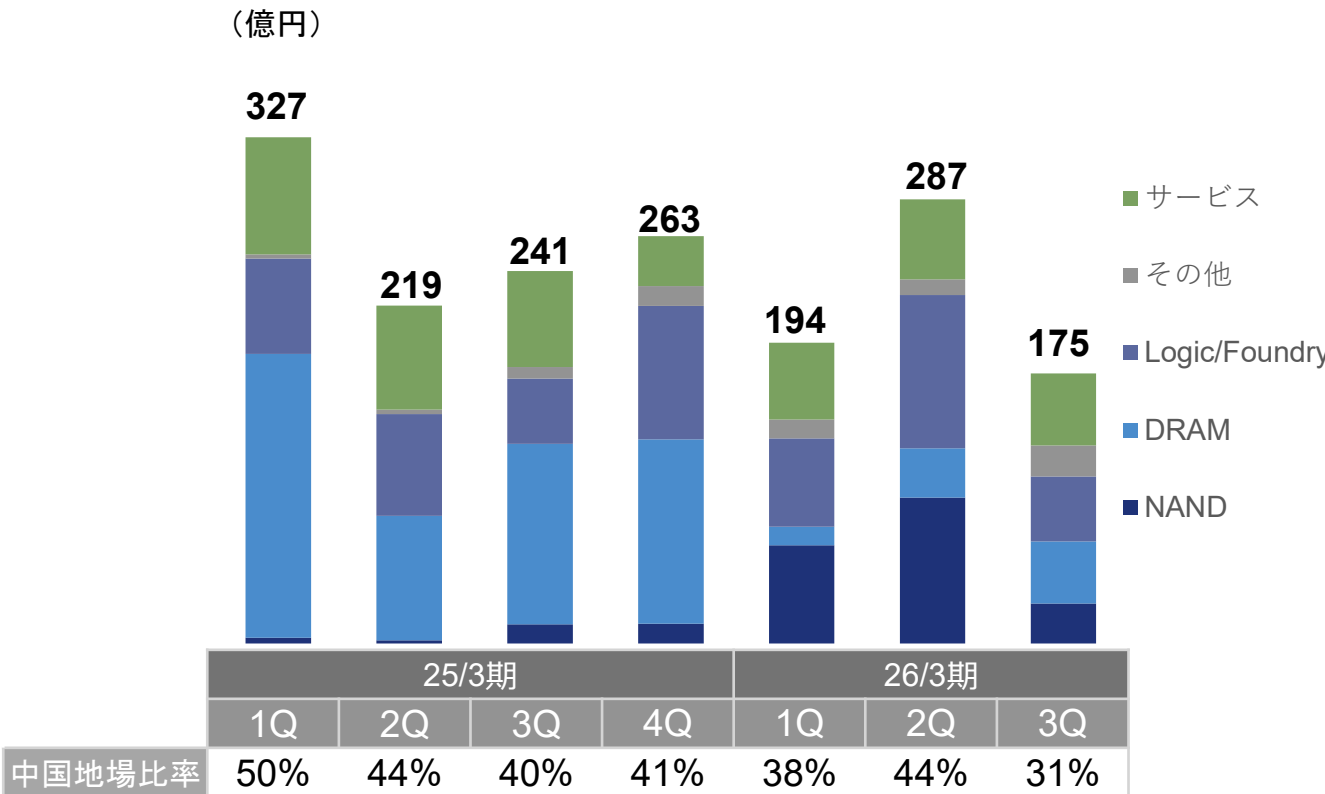
3Qの世界各国向け売上は、直前四半期比でDRAM、Logic/Foundry向け装置販売、アップグレード改造（サービス）が増加。

3Qの中国地場向け売上は、直前四半期比でNAND、Logic/Foundry向け装置販売が減少。DRAM向け装置販売は投資端境期から増加に転換。中国地場売上比率は31%に低下。

世界各国向け売上収益



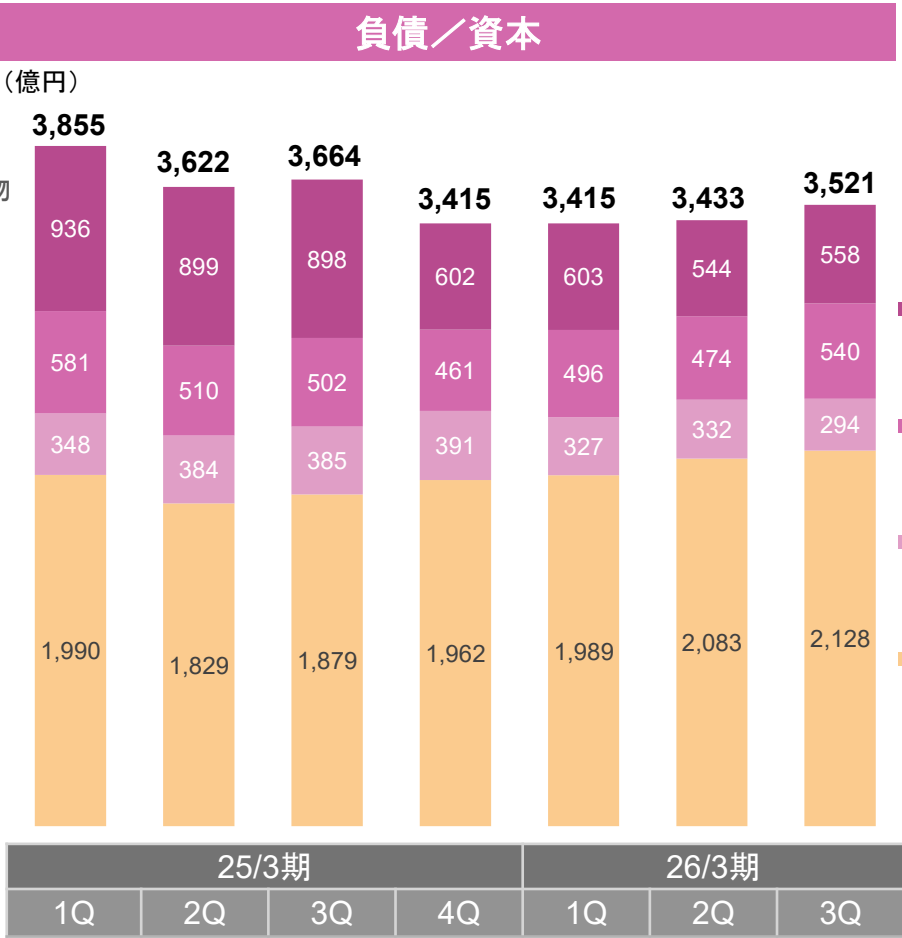
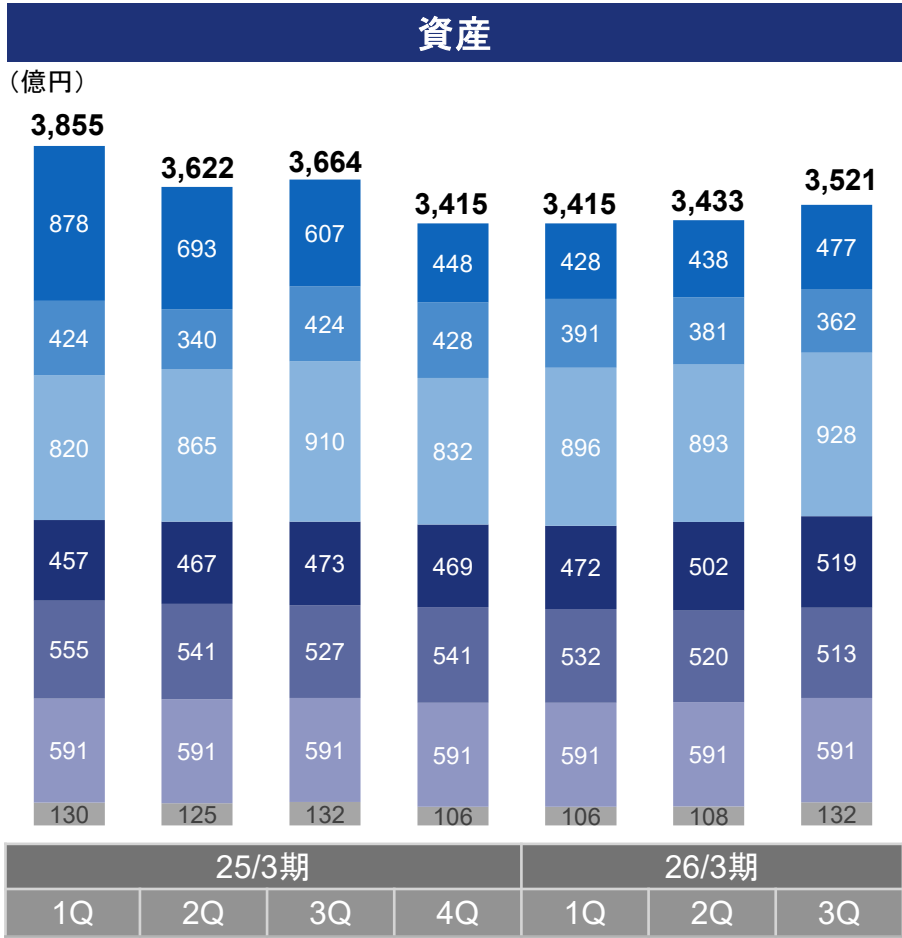
中国地場向け売上収益



\*1 世界各国デバイスメーカー（中国以外に本拠のあるメーカー）向け、中国地場デバイスメーカー向けの区分

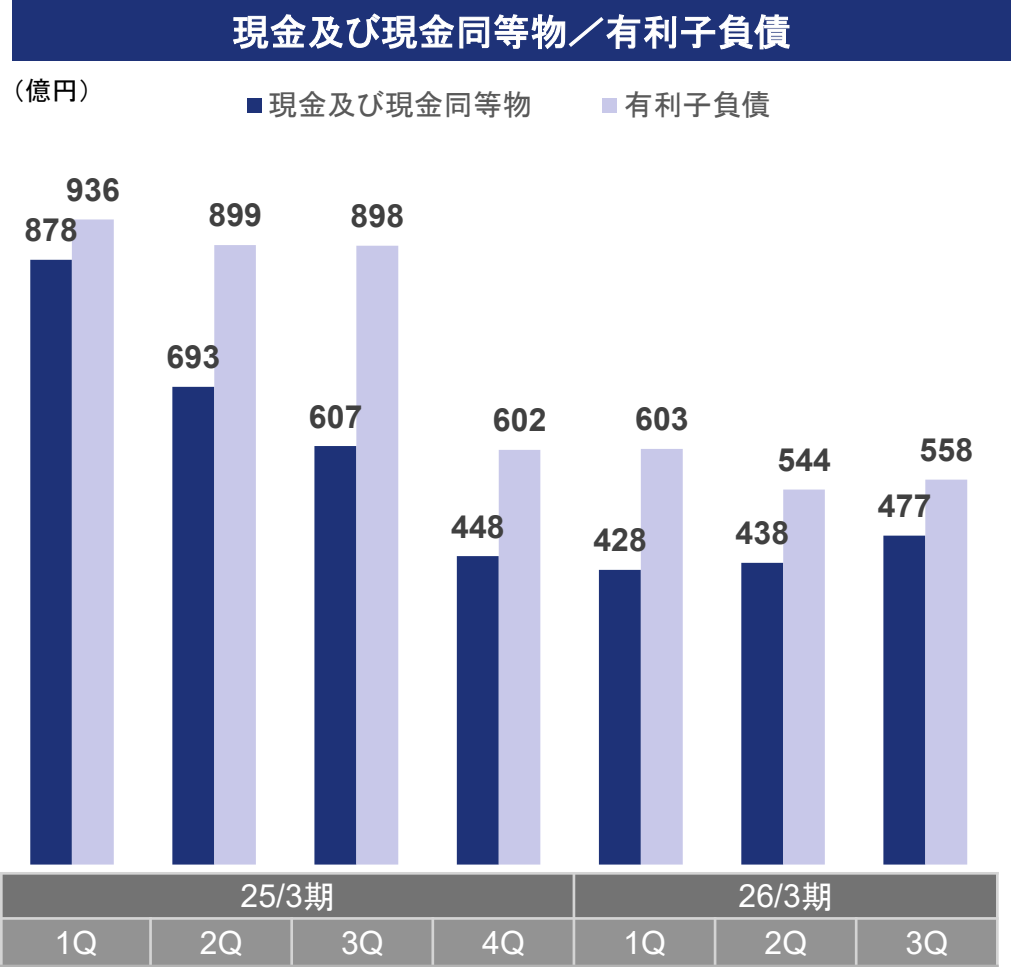
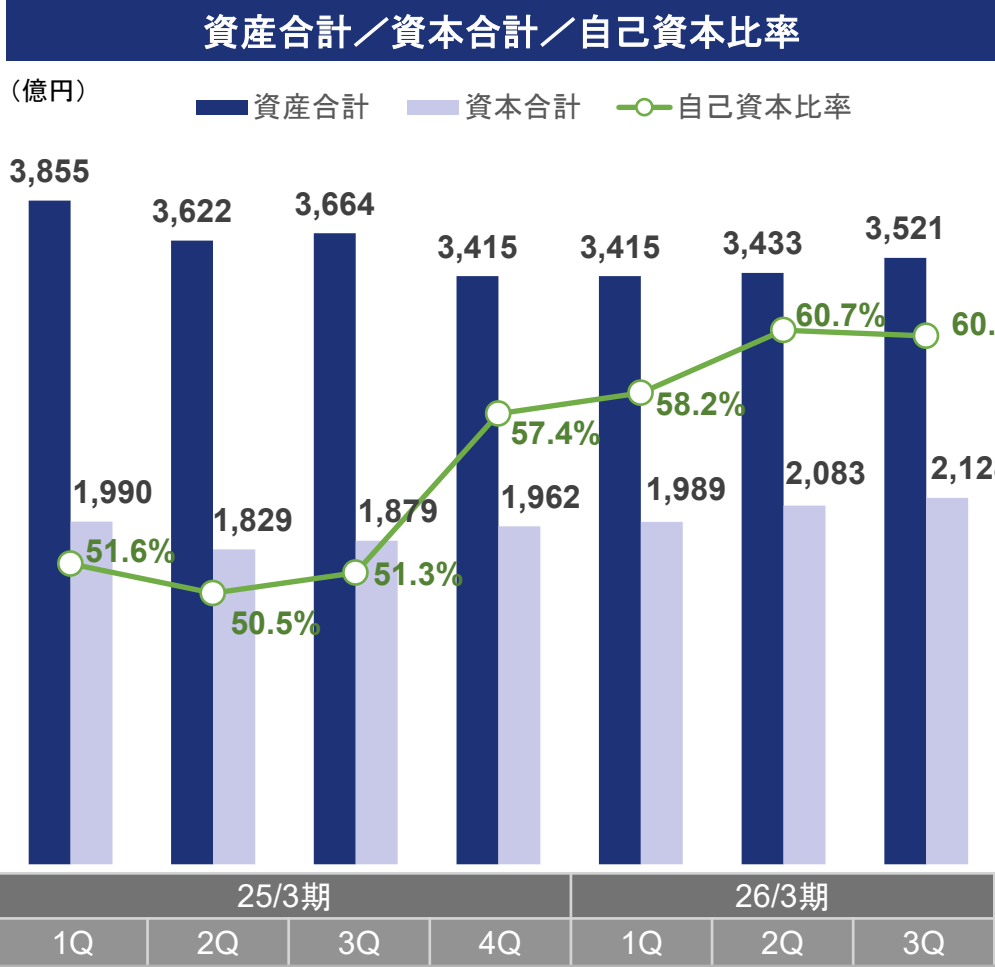
# 四半期別貸借対照表

3Q末の資産合計は、営業債権及びその他の債権等が減少したものの、棚卸資産の増加、米国デモセンター設立に伴う投資等による有形固定資産の増加により、25年3月期末比で106億円増加。  
資本合計は、利益剰余金の増加等により25年3月期末比で167億円増加。



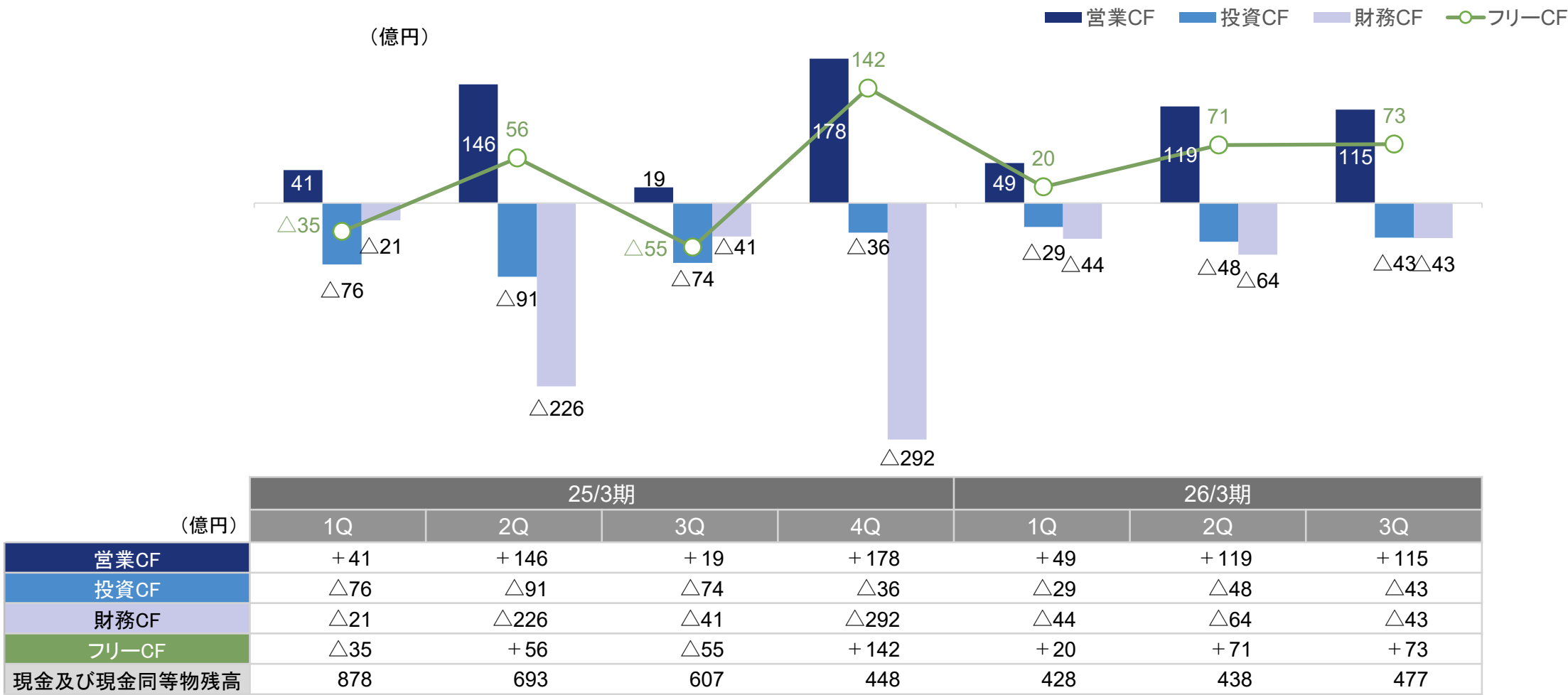
# 四半期別自己資本比率&現金及び現金同等物／有利子負債

3Q末の自己資本比率は、直前四半期末比で0.3ポイント減少し、60.4%。  
3Q末のネットデットは、概ね計画通り81億円に減少。



# 四半期別キャッシュ・フロー

3Qは、営業CFが投資CFを上回り、フリーCFは73億円の収入。  
財務CFは、配当金の支払いによる支出等で43億円の支出。

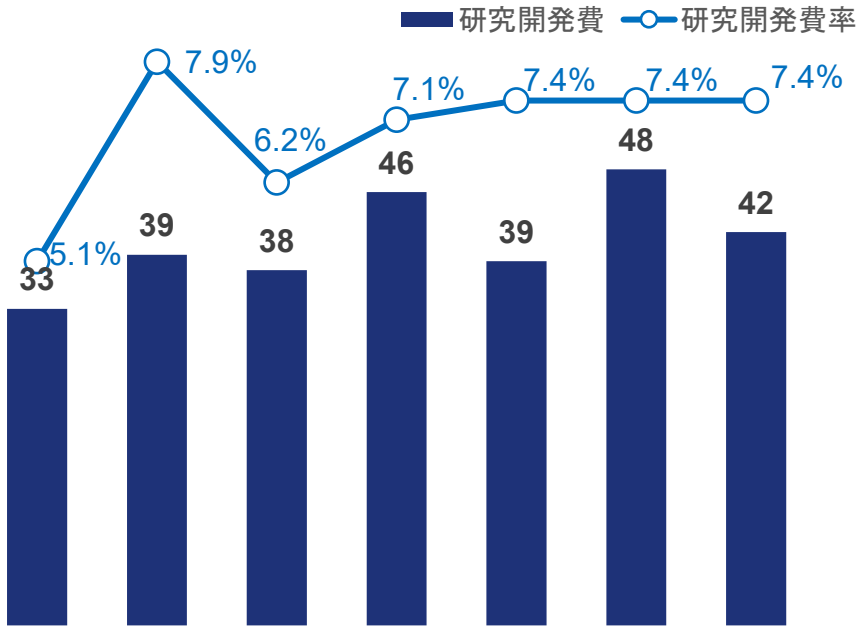


# 四半期別研究開発費／設備投資額／減価償却費

3Qの研究開発費は計画通り推移し、研究開発費率は7.4%。

研究開発費

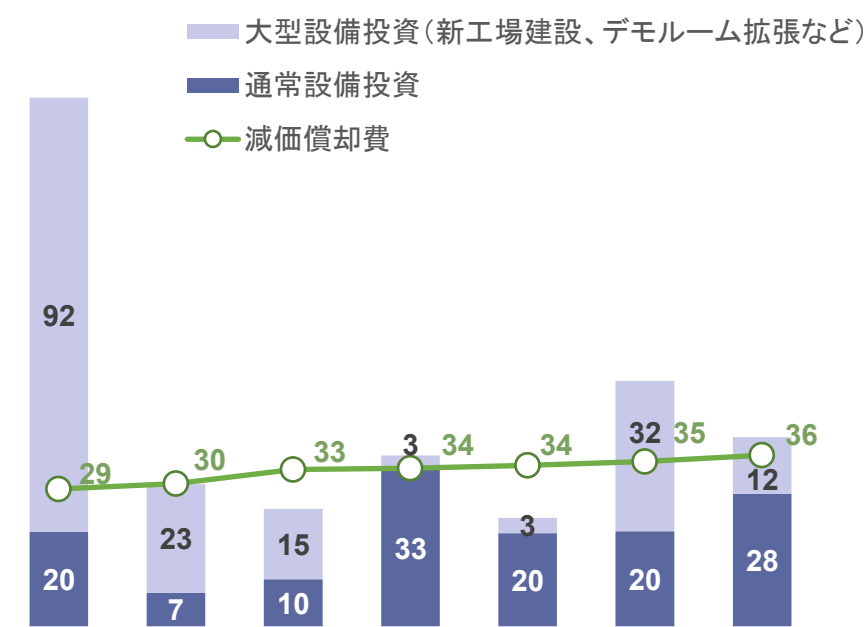
(億円)



(億円)	25/3期				26/3期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
研究開発費	33	39	38	46	39	48	42
売上収益比	5.1%	7.9%	6.2%	7.1%	7.4%	7.4%	7.4%

設備投資額／減価償却費

(億円)



(億円)	25/3期				26/3期		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
設備投資額計	112	30	25	36	23	52	40
売上収益比	17.2%	6.1%	4.1%	5.6%	4.4%	8.0%	7.2%
減価償却費	29	30	33	34	34	35	36
売上収益比	4.5%	6.1%	5.5%	5.2%	6.6%	5.3%	6.5%



## 2026年3月期連結業績予想



## 2026年3月第3四半期連結決算概要

- 半導体デバイス市場は、生成AI用途の高性能Logic、DRAMを中心に世代交代・生産規模拡大投資が高水準で推移。NANDは世代交代投資が中心。民生電子機器向けや自動車・産業機器向けの需要回復は緩やか。
- 当社3Qは、2Q決算発表時に修正した業績予想に沿って推移。世界各国DRAM向けアップグレード改造を中心にサービス売上が伸長したものの、中国地場DRAM向け装置販売等の減少により減収減益。

## 2026年3月期連結業績予想と今後の見通し

- 当社26/3期は、2Q決算発表時に修正した業績予想に沿って推移しており、業績・配当予想に変更なし。
- 世界各国メーカーでは、高性能デバイスの世代交代や生産規模拡大に向けた設備投資がさらに増加する見通し。中国地場メーカーでは、大手メーカーを中心に設備投資が増加に転じる見通し。当社では27/3期に向けて装置販売、アップグレード改造の引き合いが増加基調。

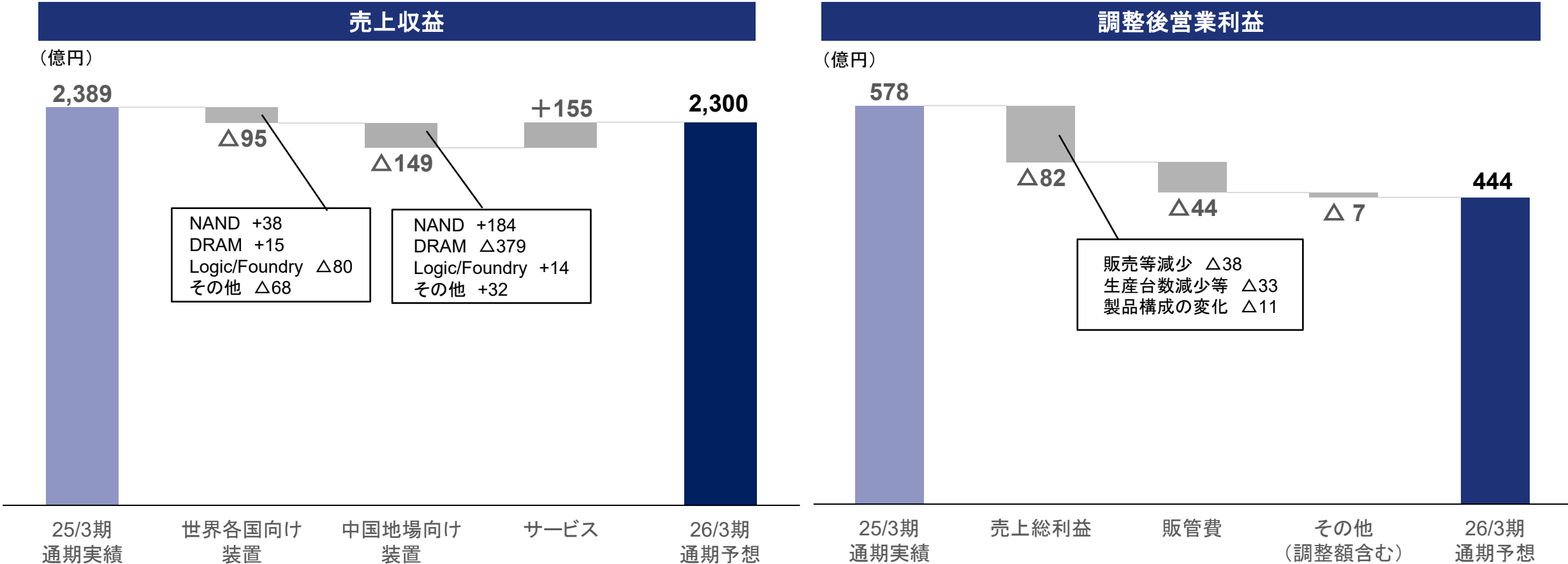
# 2026年3月期業績・配当予想(変更なし)

2Q決算発表時に修正した通期業績予想・配当予想に変更なし。

(億円)	25/3期			26/3期			
	上期実績	下期実績	通期実績	上期実績	下期予想	通期予想	前期比
売上収益	1,145	1,244	2,389	1,172	1,128	2,300	△3.7%
売上総利益	514	504	1,017	495	440	935	△8.1%
売上総利益率	44.8%	40.5%	42.6%	42.2%	39.0%	40.7%	△1.9pts
調整後営業利益	307	271	578	253	191	444	△23.1%
調整後営業利益率	26.8%	21.8%	24.2%	21.6%	17.0%	19.3%	△4.8pts
調整後当期(半期)利益	216	207	423	174	144	318	△24.8%
調整後当期(半期)利益率	18.9%	16.6%	17.7%	14.8%	12.8%	13.8%	△3.9pts
営業利益	274	239	513	227	161	388	△24.4%
営業利益率	24.0%	19.2%	21.5%	19.4%	14.3%	16.9%	△4.6pts
税引前当期(半期)利益	279	228	508	222	154	376	△26.0%
税引前当期(半期)利益率	24.4%	18.4%	21.3%	18.9%	13.7%	16.3%	△5.0pts
当期(半期)利益	181	180	360	156	123	279	△22.5%
当期(半期)利益率	15.8%	14.4%	15.1%	13.3%	10.9%	12.1%	△3.0pts
1株当たり配当金(円)	18	19	37	18	18	36	△1円
配当性向(調整後当期利益ベース)	—	—	20.4%	—	—	26.4%	+6.0pts

# 2026年3月期業績予想 増減要因(変更なし)

前期比でNAND向け装置販売は増加する一方で、中国地場DRAM向け、成熟ノードLogic向けの減少により装置売上は減少。高性能デバイス向けアップグレード改造の増加により、サービス売上は増加。  
販売の減少、生産台数の減少等、製品構成の変化による売上総利益の減少により、調整後営業利益は減少。

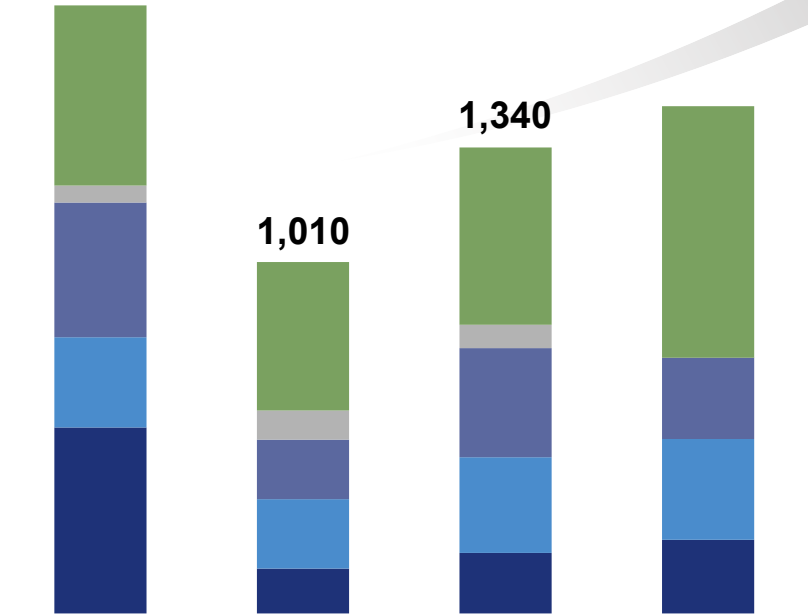


# 2026年3月期業績予想 アカウント別\*1売上収益(変更なし)

- 世界各国向け売上は、NAND、DRAM向けの装置販売とアップグレード改造(サービス)の伸長により前期比9%増加を見込む。Logic/Foundry向けは成熟ノードが低調ながらGAA関連は伸長。
- 中国地場向け売上は、投資端境期に伴うDRAM向けの装置販売減少により前期比20%減少を見込む。NAND、Logic/Foundry向けの装置販売は伸長。

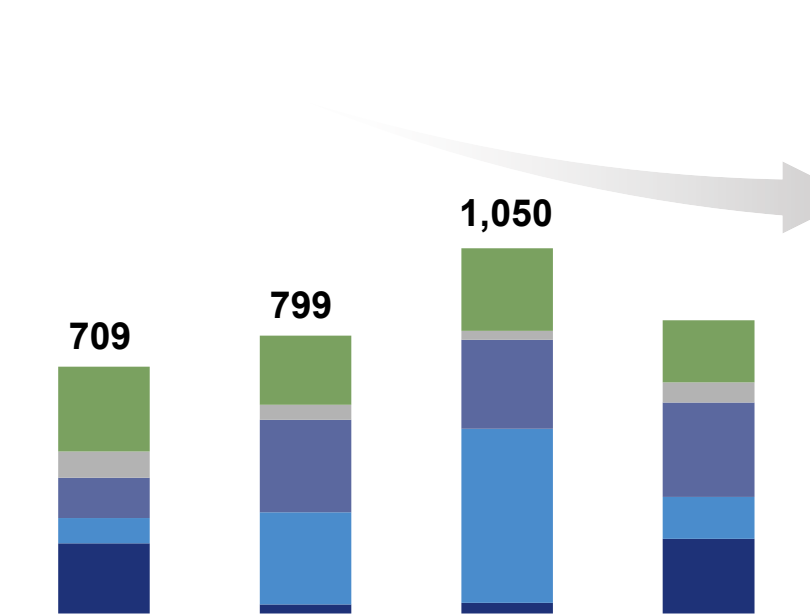
世界各国向け売上収益

(億円) 1,748



中国地場向け売上収益

(億円)



- サービス
- その他
- Logic/Foundry
- DRAM
- NAND

世界各国比率

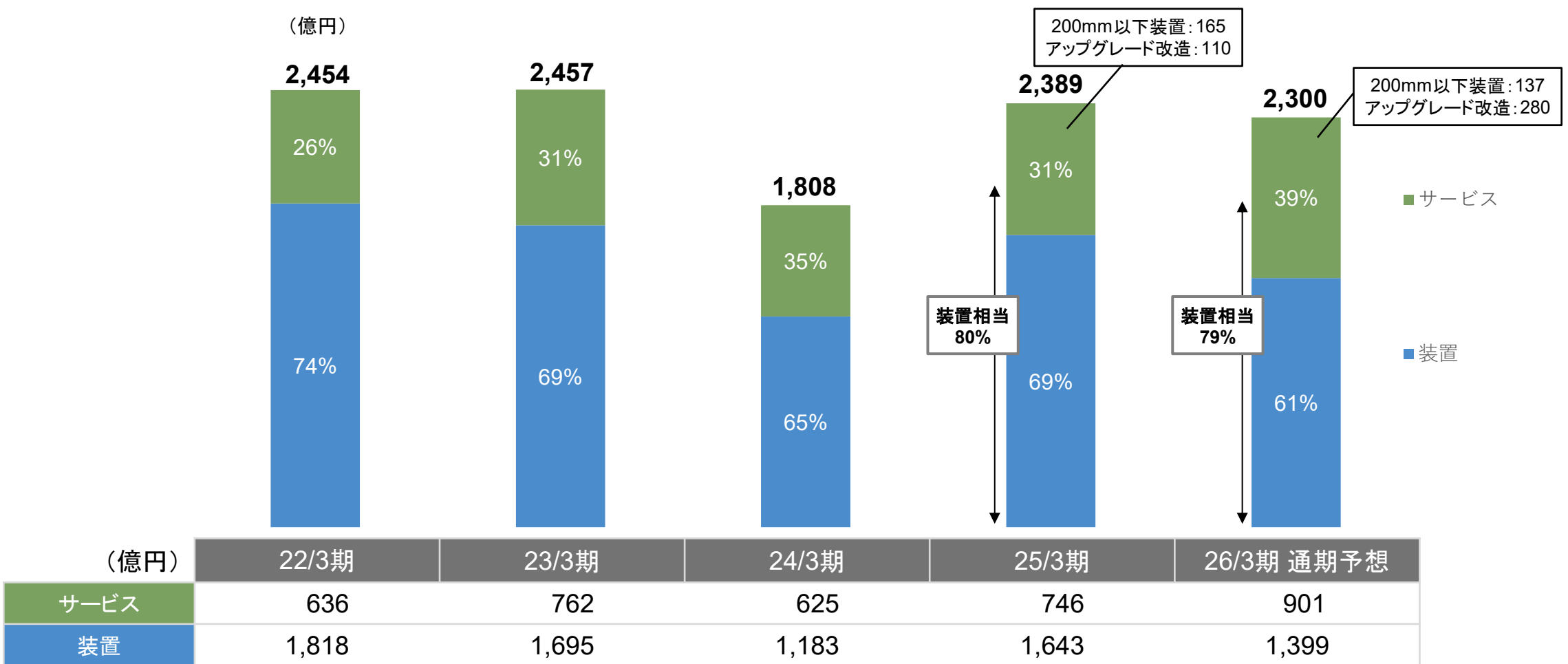
期	23/3期	24/3期	25/3期	26/3期
比率	71%	56%	56%	63%

中国地場比率

期	23/3期	24/3期	25/3期	26/3期
比率	29%	44%	44%	37%

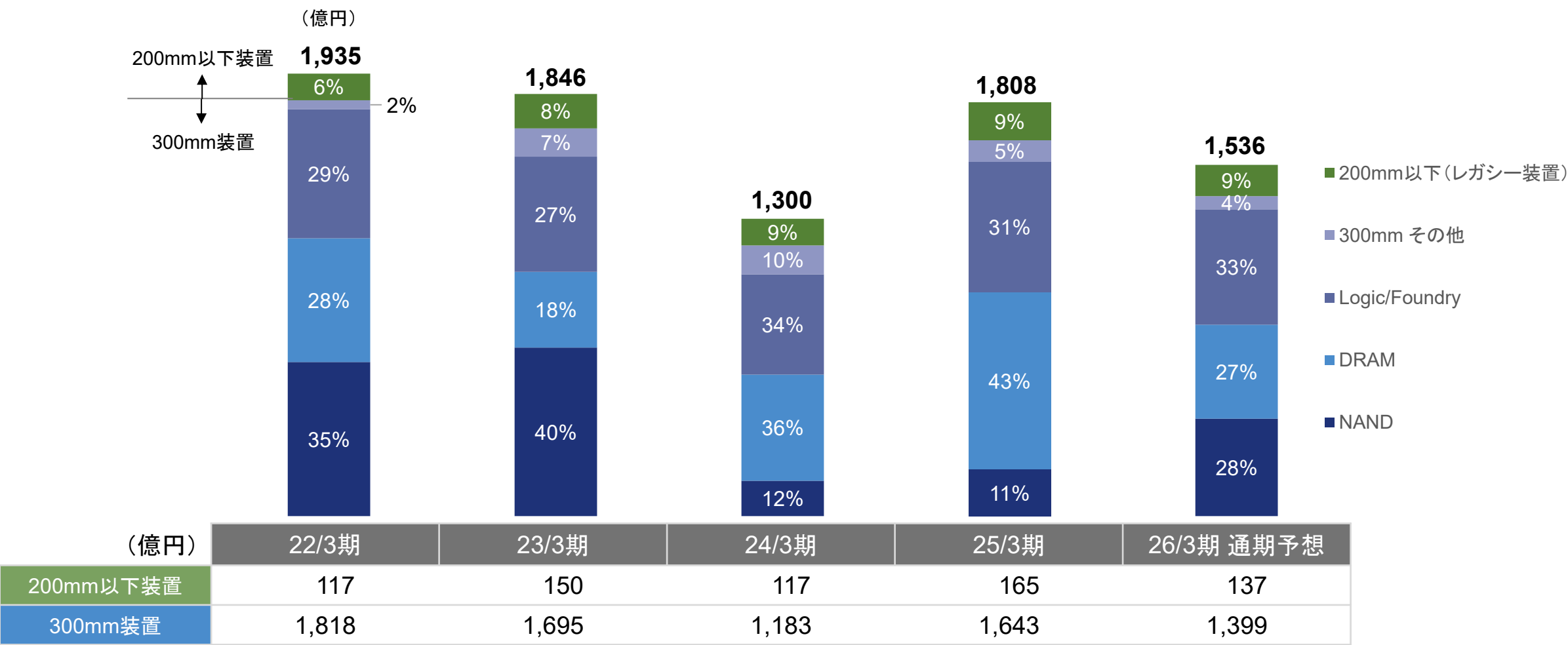
# 2026年3月期業績予想    ビジネス別売上収益(変更なし)

装置販売に代えてアップグレード改造(サービス)が増加する影響により、サービス売上比率が39%に増加する見込み。



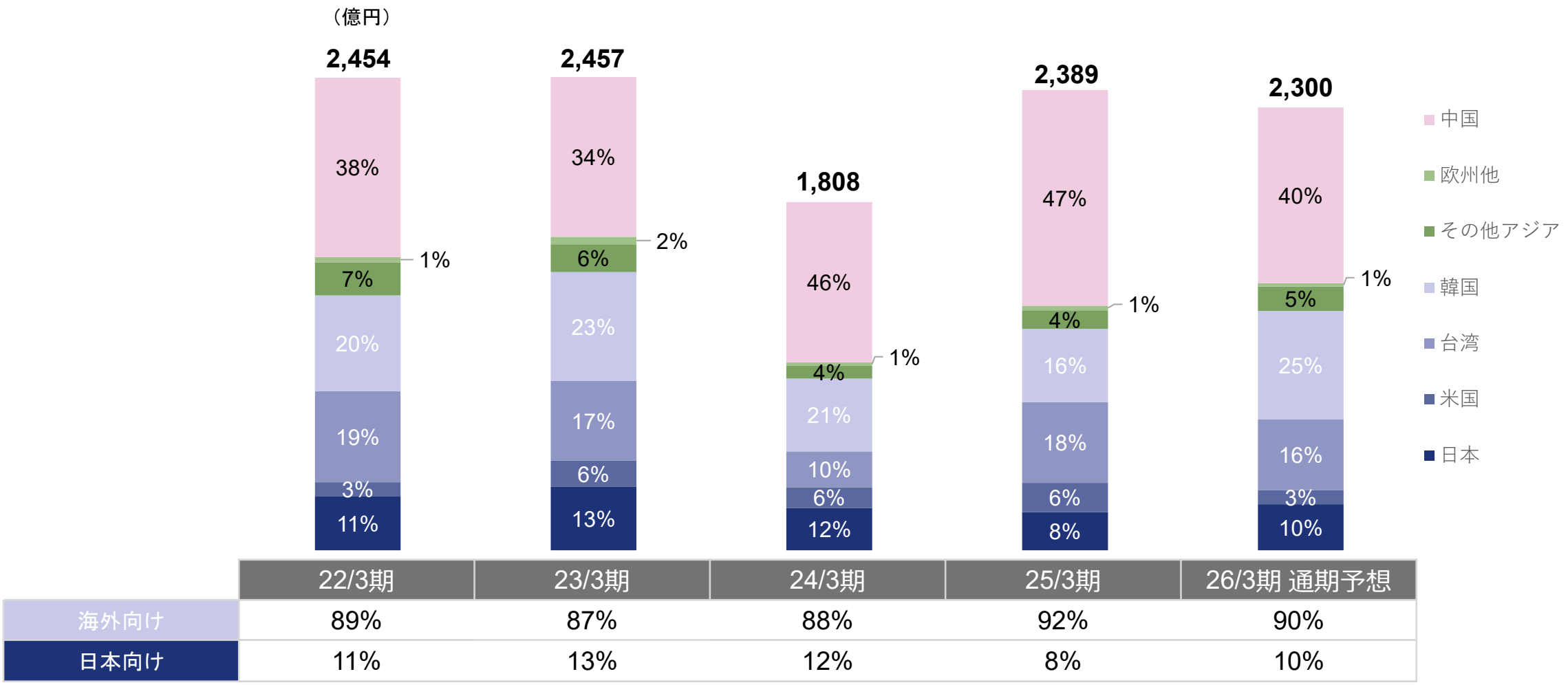
# 2026年3月期業績予想 アプリケーション別装置\*1売上収益(変更なし)

前期比でNAND向けは2倍に増加、DRAM向けは47%減(アップグレード改造を含まず)、Logic/Foundry向けは11%減、200mm以下SiC/GaNパワーデバイス向けは前期並みを見込む。



# 2026年3月期業績予想 仕向地別売上収益(変更なし)

前期比で日本、韓国、その他アジア向け売上比率は増加、中国、米国、台湾向け売上比率は減少を見込む。  
米国向け売上比率は3%にとどまる見込み。





## 今後の見通し



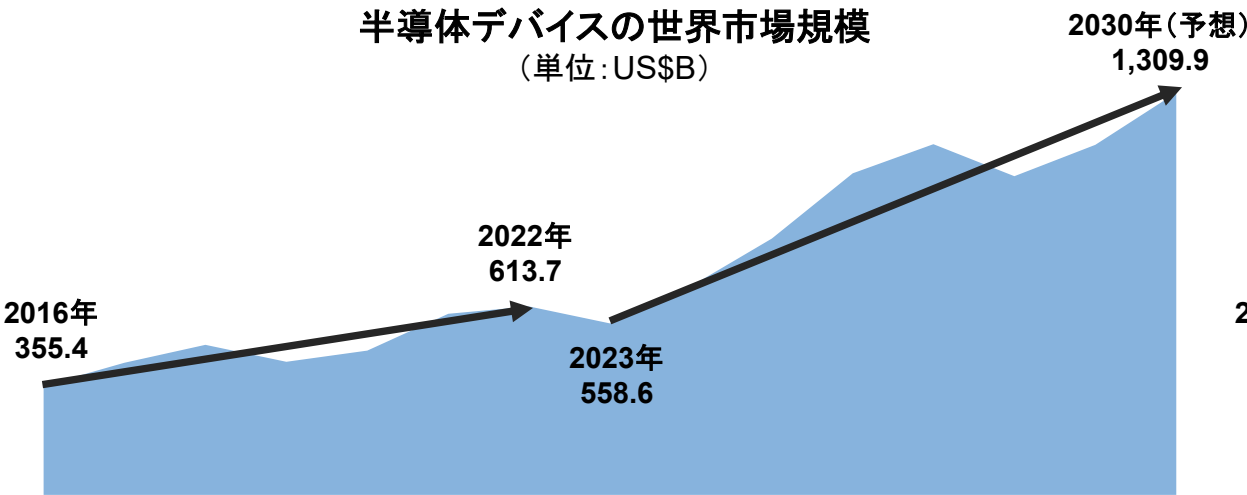
# 事業環境の見通し

生成AI関連の需要が引き続き市場をけん引、高性能デバイス向け装置需要はさらに強まる見通し。

## 半導体デバイス市場

- 生成AI関連の需要が引き続きデバイスメーカーの設備投資をけん引。高性能デバイス向けはさらに投資が増加する見通し。
- 成熟ノード向けの設備投資は欧米垂で回復に遅れ。中国でも設備投資が減速。
- 中長期的には、電子機器の需要拡大、データセンターの拡充、グリーントランスフォーメーションへの投資等により、大きな成長が期待される。

半導体デバイスの世界市場規模  
(単位: US\$B)

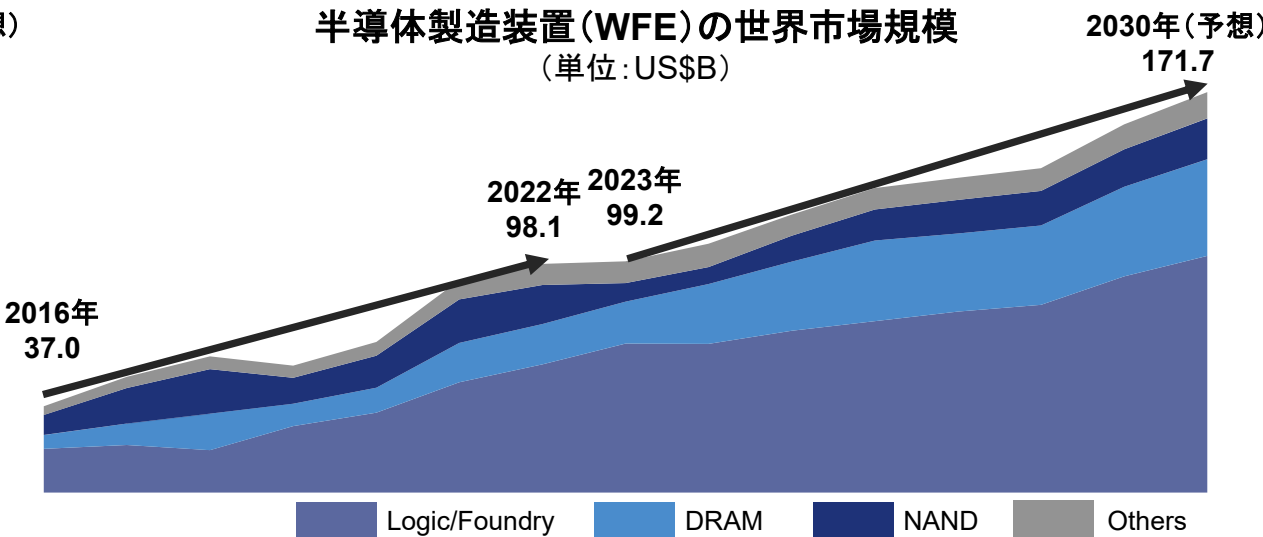


出所: Techinsights Inc. "Semiconductor Forecast" (Dec-2025)  
Techinsights Inc.-WAFER FAB EQUIPMENT (WFE) MARKET HISTORY AND FORECAST (2020 - 2030)\_Dec-25

## 半導体製造装置(WFE)市場

- 高性能デバイス向け装置需要はさらに増加する見通し。成熟ノード向けは需要低迷。中国地場向けは大手メーカー向けで需要継続。
- CY25 WFEは前年比+5%程度で着地と認識。CY26は前年比+10%程度の拡大を想定。
- 中長期的には大きな成長が期待され、数年で1,200億ドル程度まで成長するとの想定には変更なし。

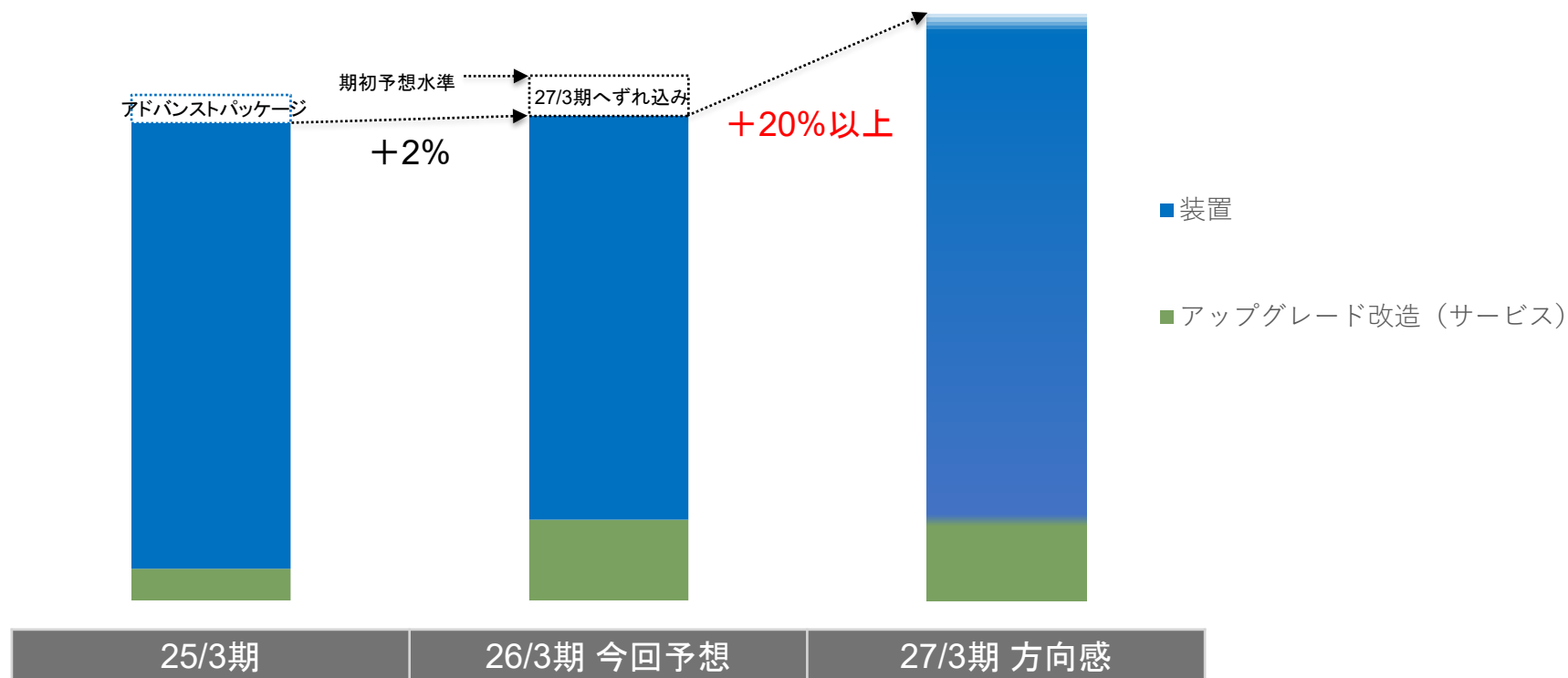
半導体製造装置(WFE)の世界市場規模  
(単位: US\$B)



# 2027年3月期の方向感(変更あり)

CY26のWFEは前年比10%程度の成長を想定。  
27/3期は、26/3期からのずれ込み分を取り込み、装置売上＋アップグレード改造売上で前期比20%以上の増収をめざす。

装置＋アップグレード改造の売上収益の推移



# アプリケーション別の事業環境と当社の状況

高性能DRAM、Logicの世代交代、生産規模拡大に向けた装置・アップグレード改造需要がさらに増加する見通し。NANDでも世代交代向けの需要が継続するものの、生産規模拡大には慎重な見方を継続。

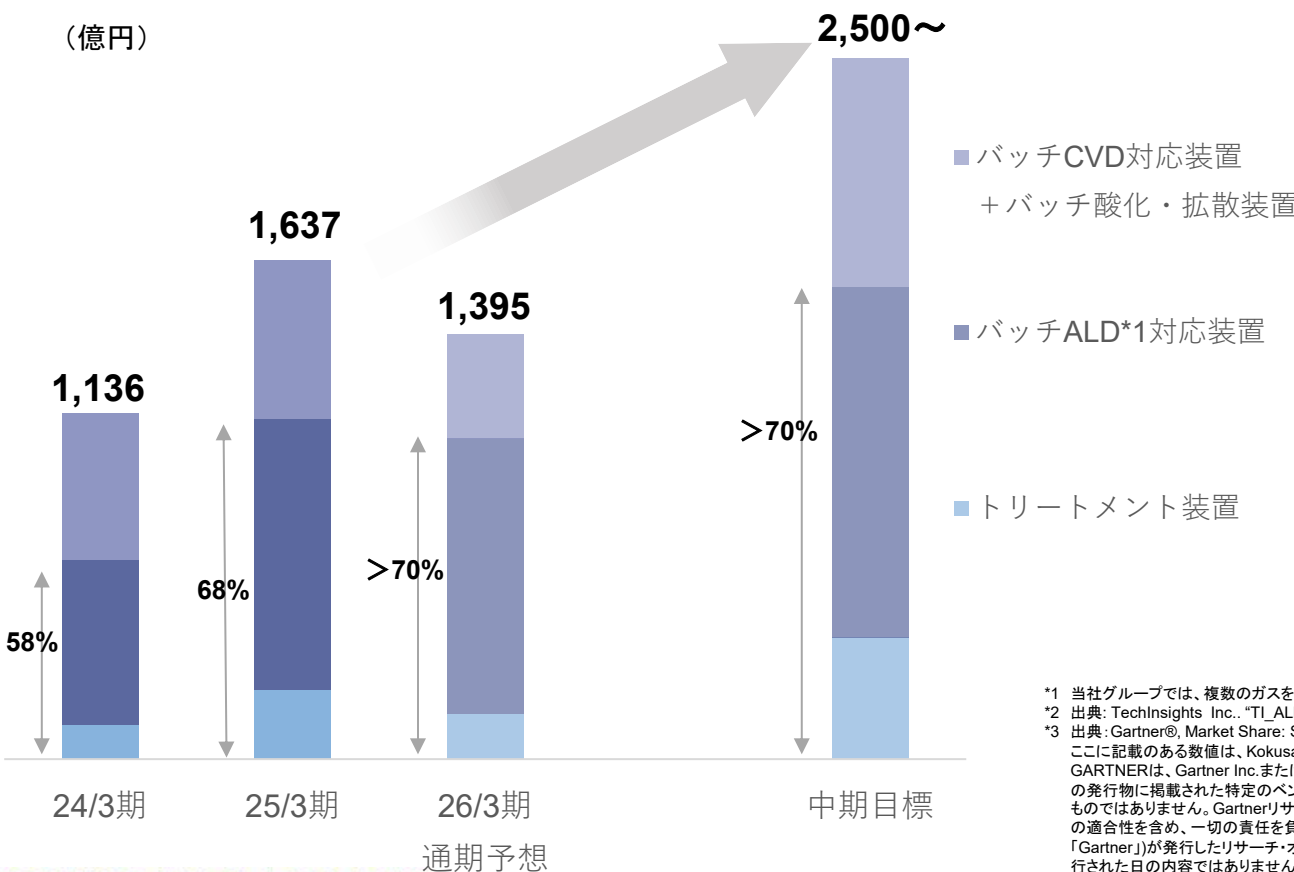
下線は、第2四半期決算発表時点からの主な変更箇所です。

	事業環境	当社
NAND	<ul style="list-style-type: none"><li>世界各国向けでデバイス世代交代に向けた設備投資が増加も、<u>慎重な投資が継続</u>。</li><li>中国地場向けでは<u>世代交代、生産規模拡大に向けた設備投資が継続</u>。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>世界各国向けでは世代交代向けを中心に<u>装置販売が増加基調</u>。<u>27/3期も売上拡大が続くと予想</u>。</li><li>中国地場向けでは世代交代と生産規模拡大向けで<u>装置販売が3期ぶりに回復</u>。<u>27/3期は上期端境期で下期中心の売上を予想</u>。</li></ul>
DRAM	<ul style="list-style-type: none"><li>HBM向けデバイスの世代交代と生産規模拡大に向けた設備投資は<u>さらに増加する見通し</u>。汎用DRAM向けも回復基調。</li><li>中国地場向けは26/3期前半の投資端境期を終え、後半から需要回復。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>世界各国向けでは<u>装置販売・アップグレード改造が増加基調</u>。<u>27/3期は成長率が前期を上回ると予想</u>。</li><li>中国地場向けでは26/3期下期から装置販売が回復。<u>27/3期は売上増加を期待</u>。</li></ul>
Logic/Foundry	<ul style="list-style-type: none"><li>先端ノード向けでは世界各国大手メーカーの積極投資が継続。</li><li>成熟ノード向けでは中国地場大手メーカーが積極投資を継続、中国新興メーカーは投資減速、欧米亜メーカーは投資停滞。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>世界各国向けではGAA第1世代向け装置販売が増加。<u>27/3期はFinFET 3nm世代向け装置販売の増加、アドバンストパッケージ向け装置販売、成熟ノード向け装置販売の回復を期待</u>。</li><li>中国地場向けは、<u>27/3期も大手メーカー向け売上拡大を期待</u>。</li></ul>
SiC/GaNパワーデバイス (サービスビジネス)	<ul style="list-style-type: none"><li>世界各国メーカー、中国地場メーカーとも設備投資は減速。</li><li>ウェーハサイズの200mm化、トレンチゲート化に伴う設備投資に期待。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><u>PORシェアは上昇し</u>、既存製品の販売は堅調。27/3期は<u>高温活性化アニール等新製品の売上増加に期待</u>。</li><li>ALD<sup>*1</sup>関連の新たなソリューション開発にも注力。</li></ul>

# 製品構成の現状と見通し(変更なし)

デバイスの世代交代に伴い、高付加価値製品の構成比が拡大。特にバッチ成膜装置のハイエンドモデルであるミニバッチ装置の販売拡大が中国地場向け売上比率の低下による影響を吸収する見通し。

装置売上(サービス売上含まず)



## バッチ処理装置

- バッチALD\*1対応装置  
世界シェア No.1 (2024年)\*2
- バッチCVD対応装置
- バッチ酸化・拡散装置



ミニバッチ成膜装置  
TSURUGI-C<sup>20</sup> 剣<sup>®</sup>  
シリーズ



ラージバッチ成膜装置  
AdvancedAce<sup>®</sup>  
シリーズ

## トリーメント装置

- Plasma Gate Modification Tools  
世界シェア No.1 (2024年)\*3
- Others



枚葉トリーメント装置  
MARORA<sup>®</sup>

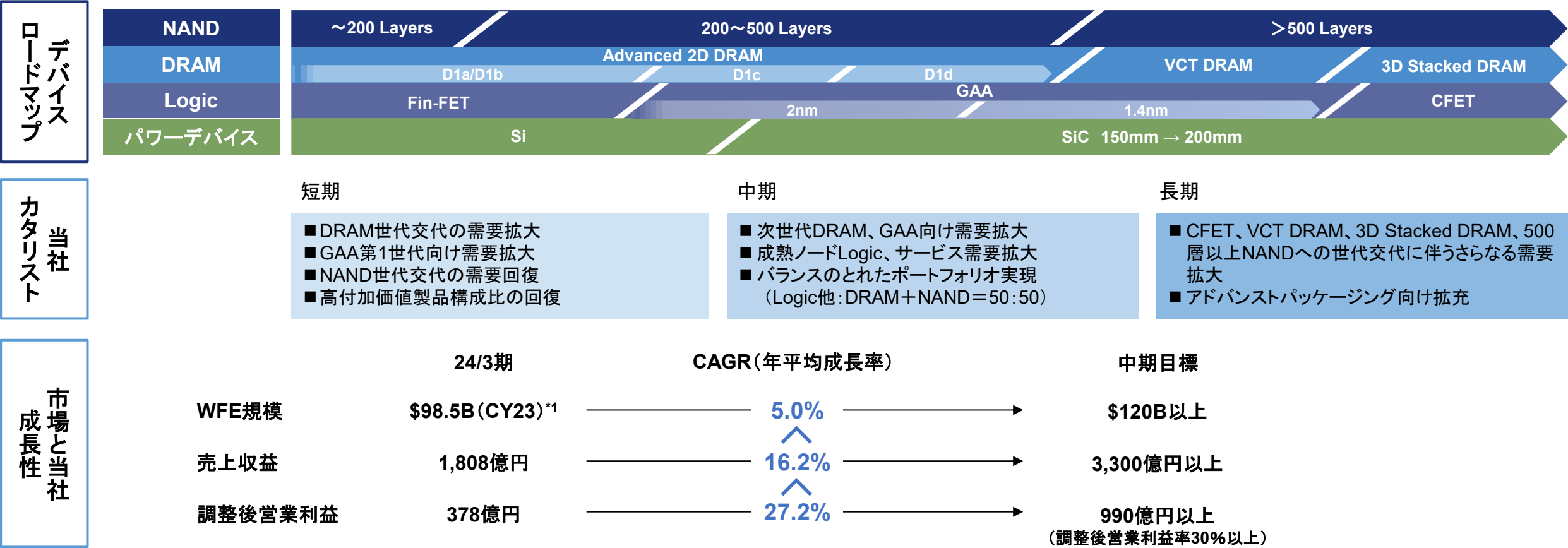


枚葉アニール装置  
TANDUO<sup>®</sup>

\*1 当社グループでは、複数のガスをサイクリックに供給する工程を伴い、原子層レベルで成膜する手法を「ALD」と呼んでいます。  
\*2 出典: TechInsights Inc.. "TI\_ALD Tools\_YEARLY" (April 2025)  
\*3 出典: Gartner®, Market Share: Semiconductor Wafer Fab Equipment, Worldwide, 2024, Bob Johnson et al, Published 21 April 2025  
ここに記載のある数値は、Kokusai Electricにより算出されたものです。トリーメント装置: RTP and Oxidation/Diffusion。  
GARTNERは、Gartner Inc.または関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークであり、同社の許可に基づいて使用しています。All rights reserved. Gartnerは、Gartnerリサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するようにテクノロジーユーザーに助言するものではありません。Gartnerリサーチの発行物は、Gartnerリサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。Gartnerは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の責任を負うものではありません。本書に記載するGartnerのコンテンツ(以下「Gartnerコンテンツ」)は、Gartnerシンジケート・サブスクリプション・サービスの一部としてGartner, Inc.(以下「Gartner」)が発行したリサーチ・オピニオンまたは見解を表すものであり、事実を述べているものではありません。Gartnerコンテンツの内容はいずれも、そのコンテンツが発行された当時の内容であり、本書が発行された日の内容ではありません。また、Gartnerコンテンツに記載されている見解は予告なく変更されることがあります。

# まとめ(5月13日公表)

半導体デバイスの進化に伴う微細化・複雑化・三次元化により高付加価値製品の適用機会が拡大、技術的優位性を生かして市場成長を上回る事業拡大をめざす。

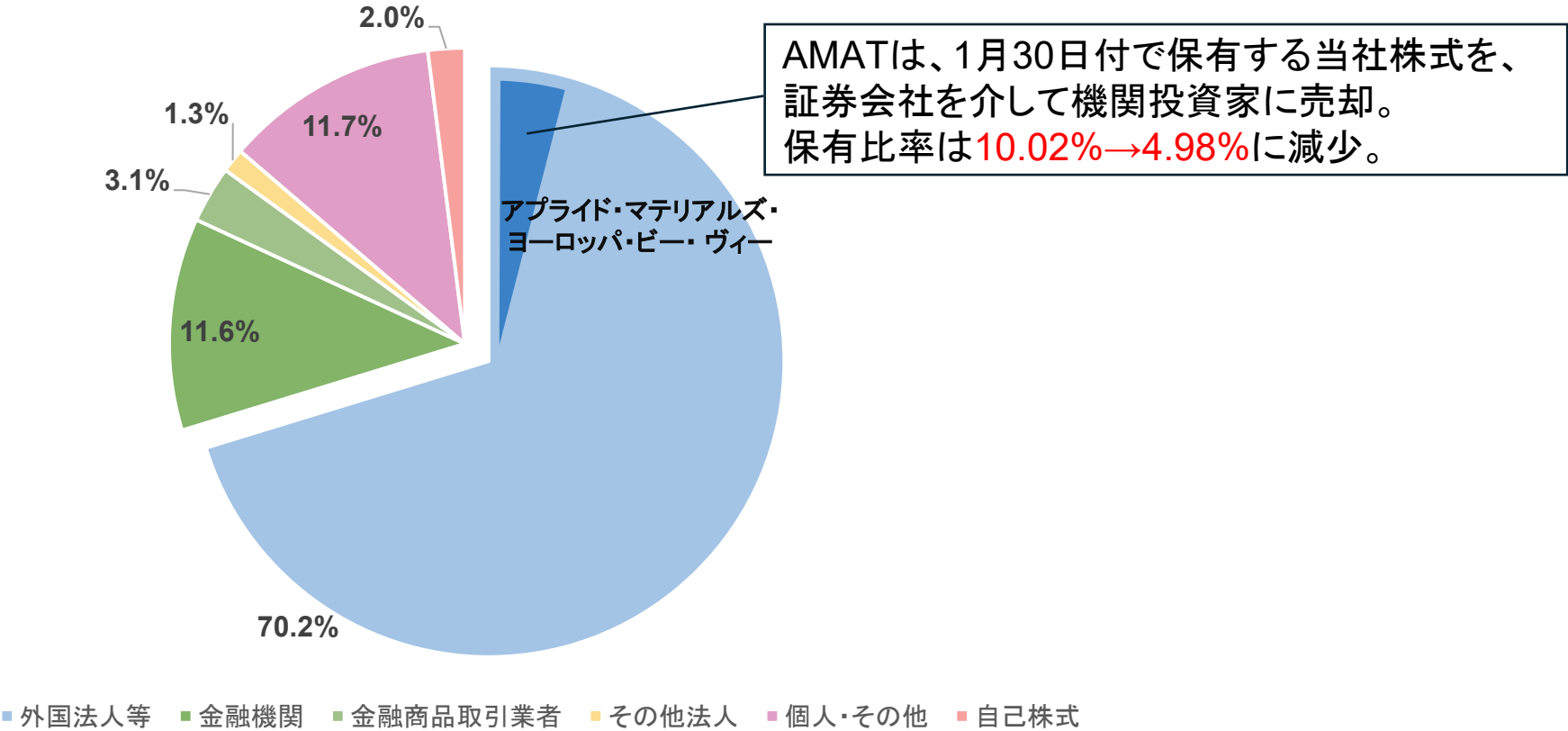


\*1 出所: TechInsights Inc. IC MANUFACTURING EQUIPMENT MARKET HISTORY AND FORECAST (2019 - 2029) (March 2025)

# AMATの当社保有株式一部売却について

AMATが当社株式の一部を機関投資家に売却し、AMATの保有比率は5%に低下。  
筆頭株主はKKRに変更なし。

株主構成(25年9月30日現在)





# 2026年3月期第3四半期の主な活動報告

## 経営・事業活動

- 「SEMICON® JAPAN 2025」に出展。(25/12)
- 環境性能に優れた高断熱ヒーターを新開発。(25/12)
- TSMCからExcellent Production Support Awardを受賞。(25/11)
- 「SEMICON® EUROPA 2025」に出展。(25/11)
- 「T-Messe2025富山県ものづくり総合見本市」に出展。(25/10)
- 韓国政府が主催する「第18回半導体の日」において「大統領表彰」を受賞。(25/10)
- 「SEMICON® WEST 2025」に出展。(25/10)



TSMCからExcellent Production Support Awardを受賞

## ESGの取り組み

- 富山事業所がRBA のVAP監査で最高評価のプラチナ・ステータスを取得。(25/12)
- SBTiよりSBT認定(Net-Zero)を取得。(25/12)
- CDP 2025においてAリスト企業に選定。(25/12)
- 富山県内で開催された「富山マラソン2025」にゴールドパートナーとして協賛。(25/11)
- 厚生労働大臣から「プラチナくるみん」「えるぼし」の認定を取得。(25/10)



「プラチナくるみん」「えるぼし」の認定を取得

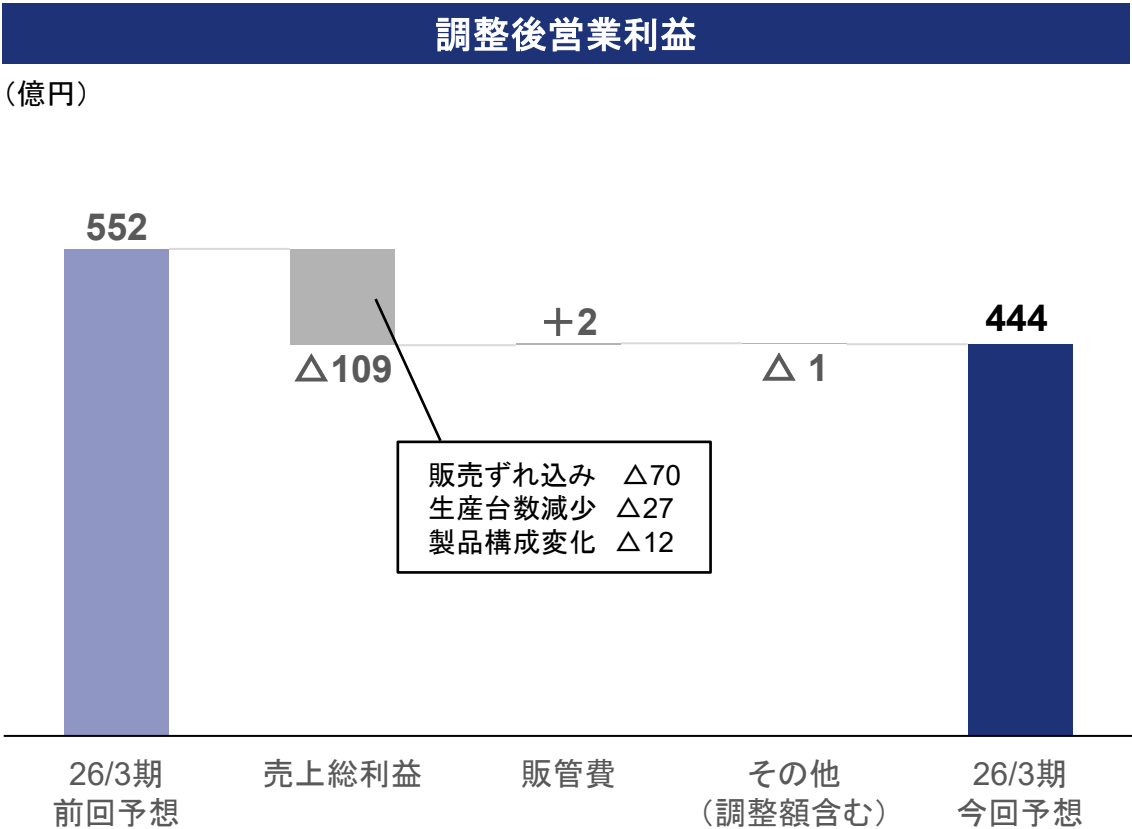
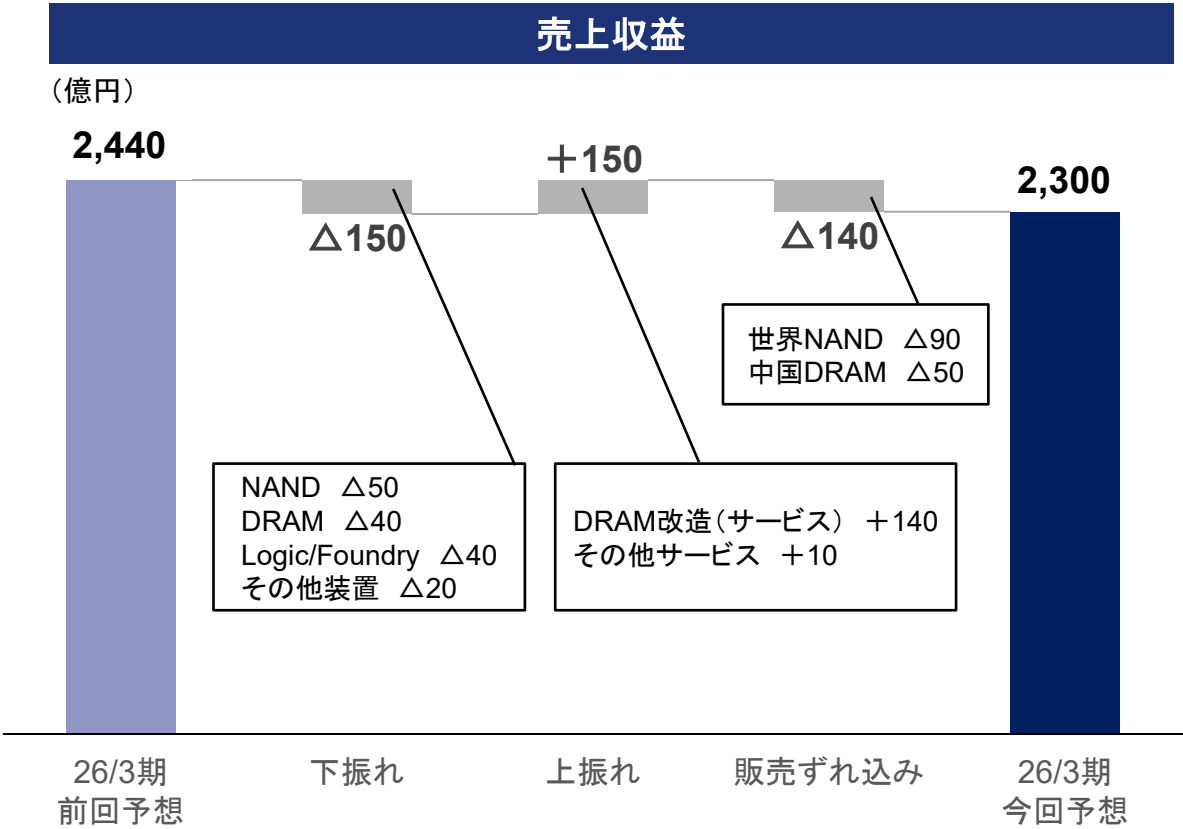


## Appendix



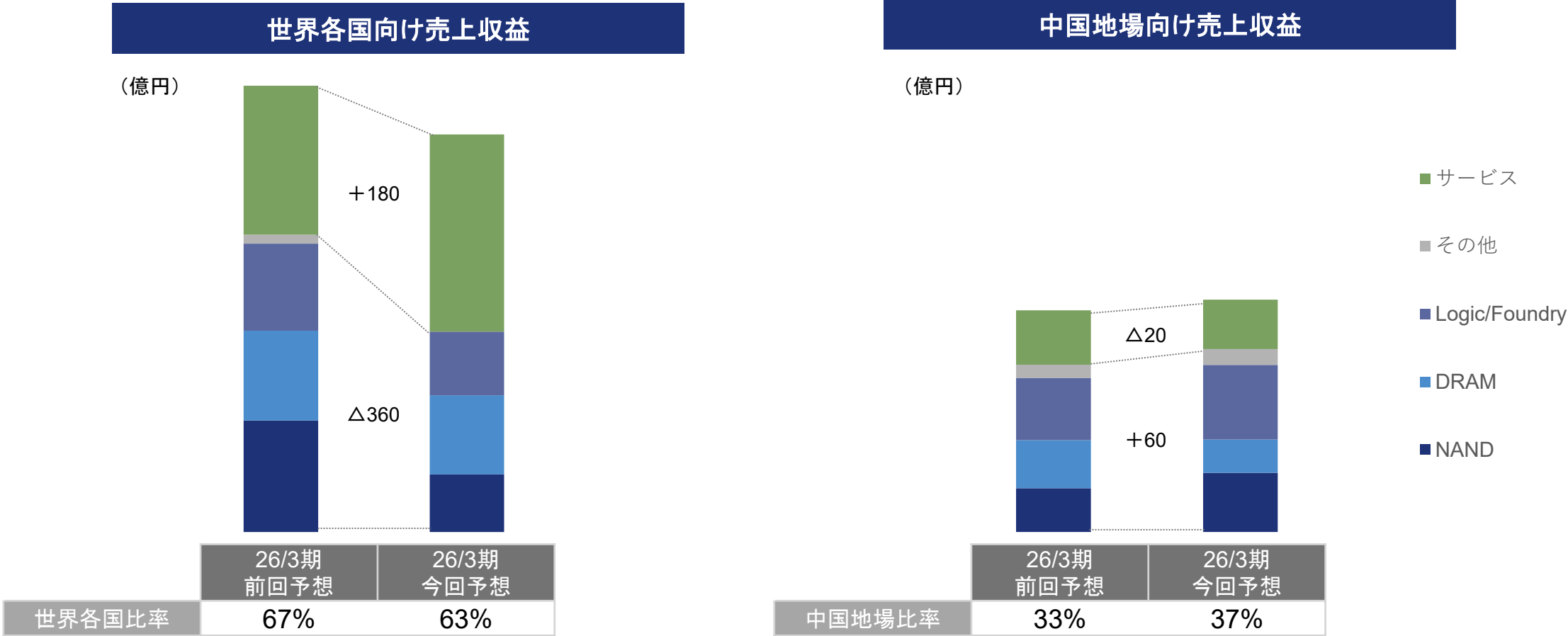
# 2026年3月期業績予想 増減要因(変更なし)

- 世界各国NAND向け、中国地場DRAM向け装置販売の27/3期へのずれ込みにより、売上予想を引き下げ。
- NAND向けとLogic/Foundry向けの下振れを、DRAM向けアップグレード改造の上振れが吸収。
- 販売等の減少、生産台数の減少、製品構成の変化による売上総利益の減少により、調整後営業利益予想を引き下げ。



# 2026年3月期業績予想 アカウント別\*1売上収益(変更なし)

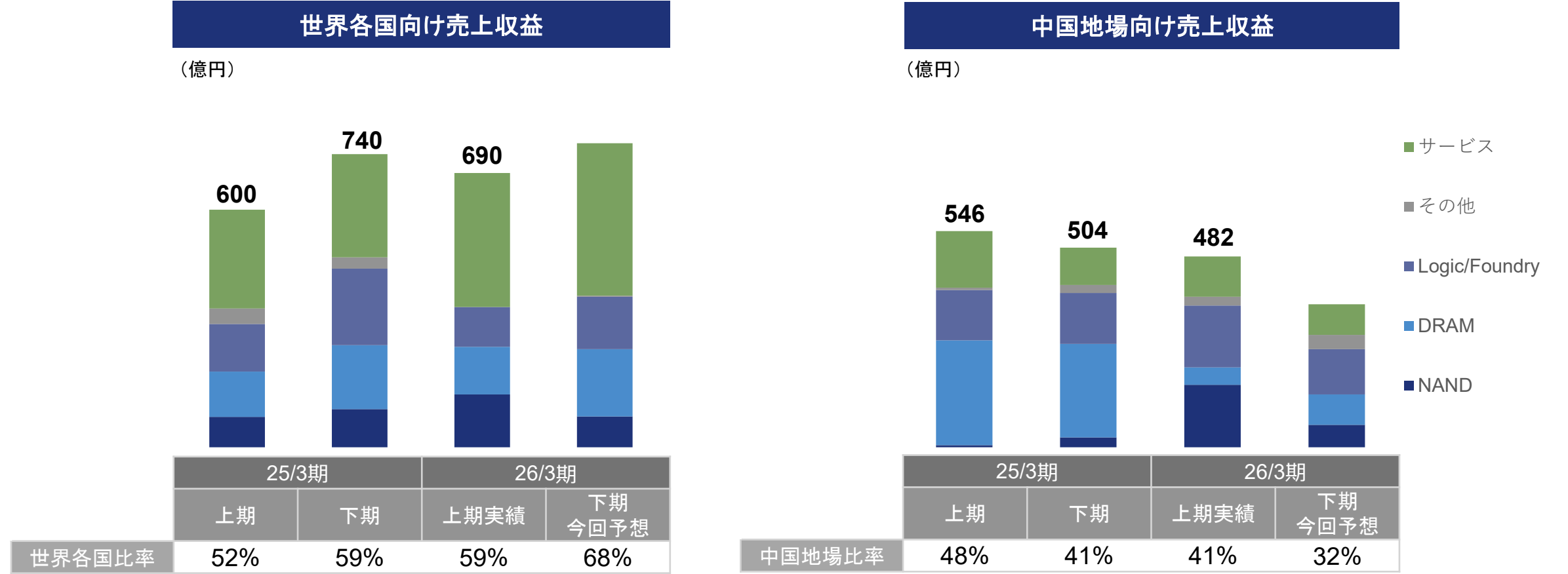
- 世界各国向け売上は前回予想比△180億円。NAND向け、Logic/Foundry向けを引き下げ。DRAM向けは引き下げもアップグレード改造を中心にサービスを引き上げ。
- 中国地場向け売上は前回予想比+40億円。NAND向け、Logic/Foundry向けを引き上げ。DRAM向けは販売ずれ込みで引き下げ。中国地場売上比率は37%を予想。



\*1 世界各国デバイスメーカー(中国以外に本拠のあるメーカー)向け、中国地場デバイスメーカー向けの区分

# 2026年3月期業績予想 上期・下期別売上収益 アカウ‌ント別\*1(変更なし)

世界各国向けは、装置販売の一部が下期から27/3期にずれ込むものの、売上増加基調が継続。  
中国地場向けは、装置販売の一部が下期から上期へ、一部が下期から27/3期へずれ込む影響で売上減少傾向が続くものの、26/3期が底となる見通し。



\*1 世界各国デバイスメーカー(中国以外に本拠のあるメーカー)向け、中国地場デバイスメーカー向けの区分

# 損益計算書及び研究開発費、設備投資額、減価償却費

(百万円)	25/3期						26/3期			
	1Q	2Q	3Q	3Q累計	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	3Q累計
売上収益	65,224	49,324	60,117	174,665	64,268	238,933	51,789	65,416	55,852	173,058
売上総利益	29,354	22,012	24,865	76,231	25,512	101,743	22,220	27,277	22,883	72,380
売上総利益率	45.0%	44.6%	41.4%	43.6%	39.7%	42.6%	42.9%	41.7%	41.0%	41.8%
調整後営業利益	19,382	11,299	13,876	44,557	13,196	57,753	10,902	14,439	11,290	36,631
調整後営業利益率	29.7%	22.9%	23.1%	25.5%	20.5%	24.2%	21.1%	22.1%	20.2%	21.2%
調整後当期(四半期)利益	14,345	7,262	9,646	31,253	11,050	42,303	7,598	9,785	8,292	25,675
調整後当期(四半期)利益率	22.0%	14.7%	16.0%	17.9%	17.2%	17.7%	14.7%	15.0%	14.8%	14.8%
営業利益	17,878	9,562	12,274	39,714	11,606	51,320	9,717	12,993	9,809	32,519
営業利益率	27.4%	19.4%	20.4%	22.7%	18.1%	21.5%	18.8%	19.9%	17.6%	18.8%
税引前当期(四半期)利益	17,747	10,195	11,241	39,183	11,606	50,789	9,322	12,840	9,412	31,574
税引前当期(四半期)利益率	27.2%	20.7%	18.7%	22.4%	18.1%	21.3%	18.0%	19.6%	16.9%	18.2%
当期(四半期)利益	13,302	4,751	8,004	26,057	9,947	36,004	6,776	8,782	7,264	22,822
当期(四半期)利益率	20.4%	9.6%	13.3%	14.9%	15.5%	15.1%	13.1%	13.4%	13.0%	13.2%
研究開発費	3,348	3,920	3,755	11,023	4,581	15,604	3,851	4,821	4,159	12,831
設備投資額	11,215	3,015	2,494	16,724	3,624	20,348	2,302	5,208	4,015	11,525
減価償却費	2,914	3,027	3,328	9,268	3,357	12,625	3,417	3,498	3,629	10,544

# 調整後利益等の計算における調整項目

(百万円)	25/3期						26/3期			
	1Q	2Q	3Q	3Q累計	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	3Q累計
営業利益	17,878	9,562	12,274	39,714	11,606	51,320	9,717	12,993	9,809	32,519
－その他の収益	△92	△187	△28	△307	△41	△348	△304	△83	△70	△457
＋その他の費用	27	78	79	184	69	253	18	53	74	145
(調整額)										
＋企業結合により識別した無形資産等の償却	1,479	1,477	1,475	4,431	1,476	5,907	1,476	1,476	1,477	4,429
＋スタンドアローン関連費用	12	298	3	313	4	317	-	-	-	-
＋株式報酬費用(業績連動型株式報酬制度に係るものを除く)	78	71	73	222	82	304	△5	-	-	△5
調整額 計	1,569	1,846	1,551	4,966	1,562	6,528	1,471	1,476	1,477	4,424
調整後営業利益	19,382	11,299	13,876	44,557	13,196	57,753	10,902	14,439	11,290	36,631
当期(四半期)利益	13,302	4,751	8,004	26,057	9,947	36,004	6,776	8,782	7,264	22,822
－その他の収益	△92	△187	△28	△307	△41	△348	△304	△83	△70	△457
＋その他の費用	27	78	79	184	69	253	18	53	74	145
(調整額)										
＋企業結合により識別した無形資産等の償却	1,479	1,477	1,475	4,431	1,476	5,907	1,476	1,476	1,477	4,429
＋スタンドアローン関連費用	12	298	3	313	4	317	-	-	-	-
＋株式報酬費用(業績連動型株式報酬制度に係るものを除く)	78	71	73	222	82	304	△5	-	-	△5
－調整項目に対する税金調整額	△461	△531	△491	△1,483	△487	△1,970	△363	△443	△453	△1,259
＋一時的な税金費用の調整額	-	1,305	531	1,836	-	1,836	-	-	-	-
調整後当期(四半期)利益	14,345	7,262	9,646	31,253	11,050	42,303	7,598	9,785	8,292	25,675

# 貸借対照表及び主要財務指標

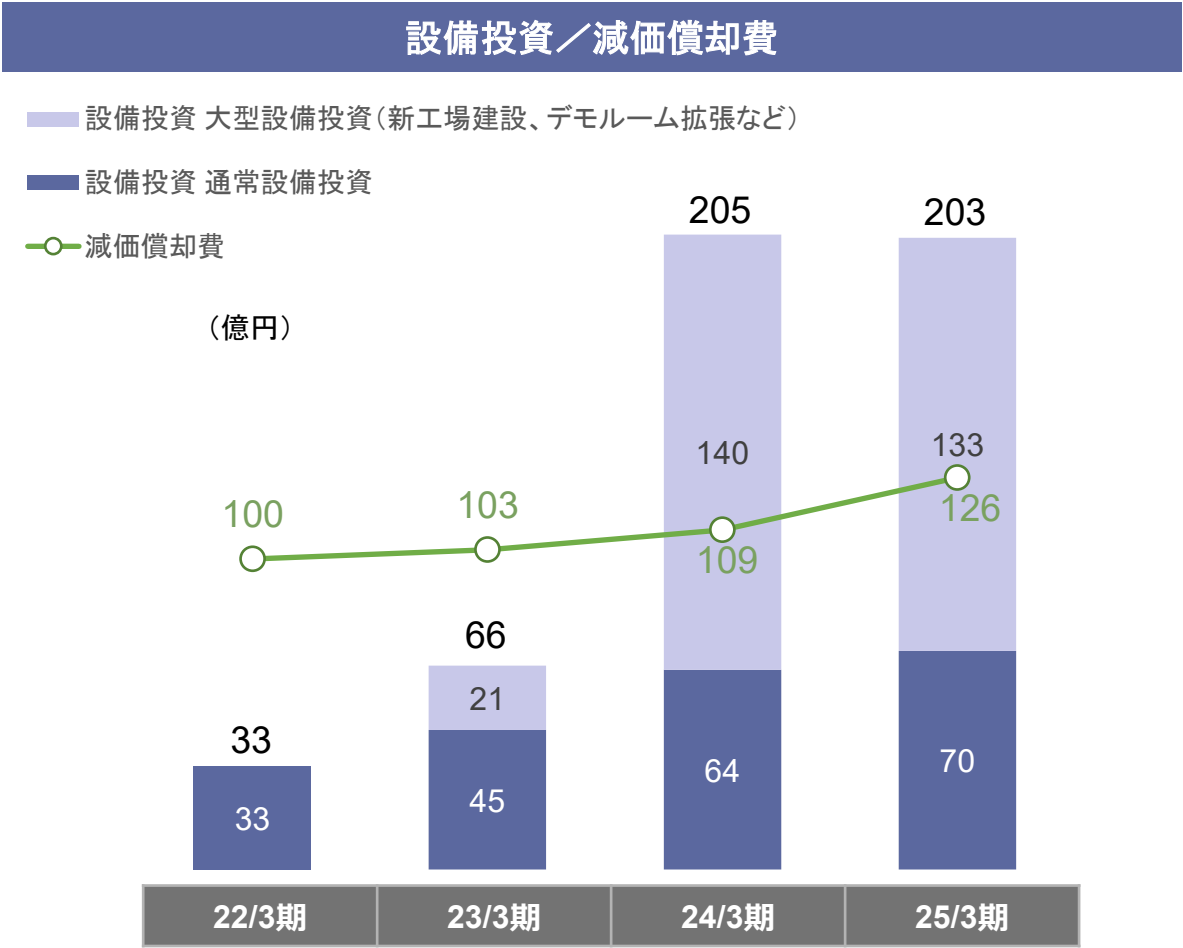
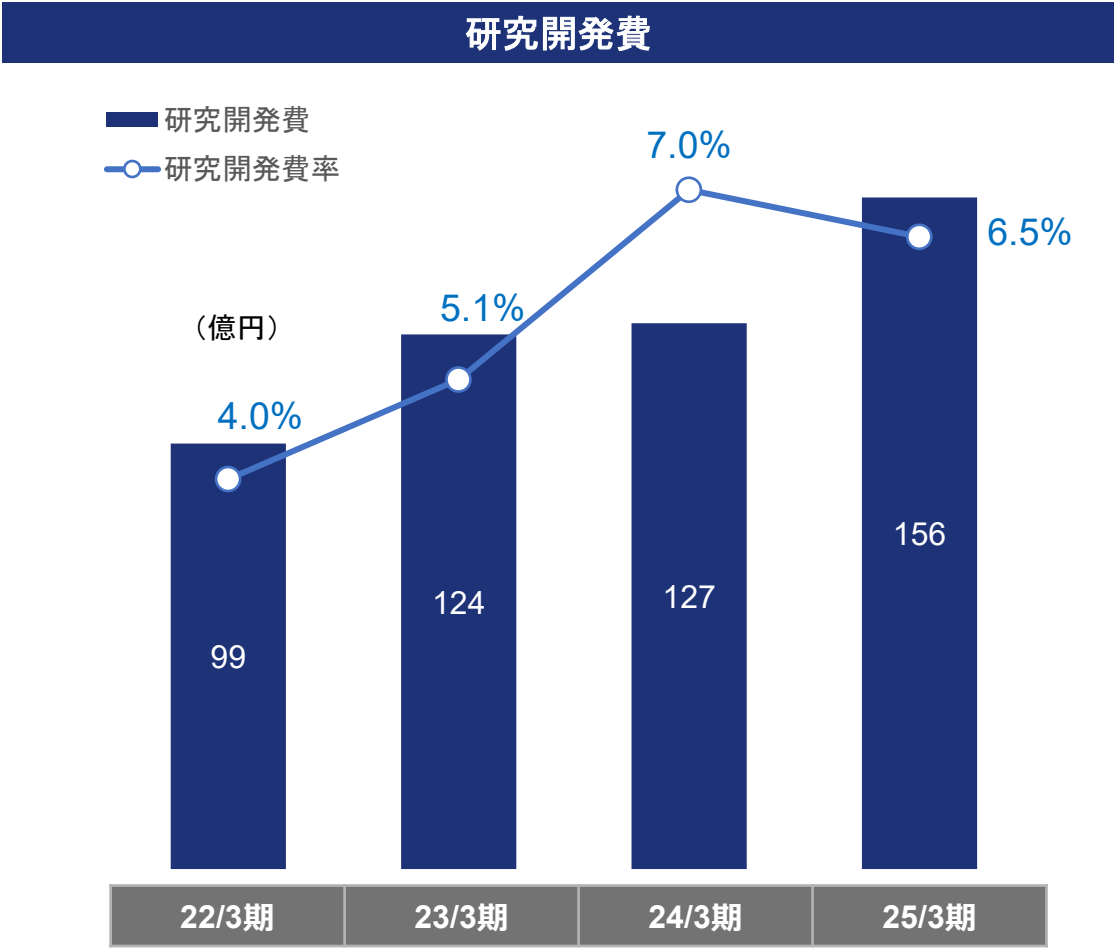
			25/3期				26/3期					25/3期				26/3期				
(百万円)			1Q末	2Q末	3Q末	4Q末	1Q末	2Q末	3Q末	(百万円)		1Q末	2Q末	3Q末	4Q末	1Q末	2Q末	3Q末		
資産	流動資産	現金及び現金同等物	87,775	69,333	60,722	44,755	42,766	43,806	47,728	負債	流動負債	借入金＋リース負債	8,055	8,843	8,843	11,928	11,956	12,044	12,161	
		営業債権及びその他の債権	42,444	33,979	42,369	42,835	39,087	38,066	36,152			営業債務及びその他の債務	38,657	31,275	30,328	23,606	24,574	25,658	26,361	
		棚卸資産	82,028	86,542	91,019	83,200	89,626	89,326	92,758			契約負債	19,394	19,734	19,822	22,455	25,069	21,704	27,666	
		その他	2,787	1,923	1,923	2,062	2,038	2,065	2,905			その他	19,554	22,510	23,180	24,682	17,991	18,687	15,263	
		流動資産合計	215,034	191,777	196,033	172,852	173,517	173,263	179,543			流動負債合計	85,660	82,362	82,173	82,671	79,590	78,093	81,451	
	非流動資産	有形固定資産	45,696	46,714	47,341	46,904	47,220	50,214	51,916		非流動負債	借入金＋リース負債	85,555	81,059	80,982	48,256	48,339	42,365	43,681	
		のれん	59,065	59,065	59,065	59,065	59,065	59,065	59,065			その他	15,199	15,900	15,344	14,417	14,663	14,553	14,131	
		無形資産	55,480	54,073	52,652	54,139	53,182	52,013	51,321			非流動負債合計	100,754	96,959	96,326	62,673	63,002	56,918	57,812	
		その他	10,179	10,609	11,309	8,552	8,524	8,765	10,262			負債合計		186,414	179,321	178,499	145,344	142,592	135,011	139,263
		非流動資産合計	170,420	170,461	170,367	168,660	167,991	170,057	172,564			資本合計		199,040	182,917	187,901	196,168	198,916	208,309	212,844
資産合計			385,454	362,238	366,400	341,512	341,508	343,320	352,107	負債及び資本合計		385,454	362,238	366,400	341,512	341,508	343,320	352,107		
											25/3期				26/3期					
											1Q末	2Q末	3Q末	4Q末	1Q末	2Q末	3Q末			
自己資本比率											51.6%	50.5%	51.3%	57.4%	58.2%	60.7%	60.4%			
D/Eレシオ											0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3			
ネット・キャッシュ(百万円)											△ 5,835	△ 20,569	△ 29,103	△ 15,429	△ 17,529	△ 10,603	△ 8,114			

# キャッシュ・フロー計算書

(百万円)	25/3期						26/3期			
	1Q	2Q	3Q	3Q累計	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	3Q累計
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,073	14,649	1,936	20,658	17,819	38,477	4,923	11,936	11,538	28,397
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,582	△ 9,090	△ 7,393	△ 24,065	△ 3,641	△ 27,706	△ 2,942	△ 4,789	△ 4,263	△ 11,994
フリー・キャッシュ・フロー	△ 3,509	5,559	△ 5,457	△ 3,407	14,178	10,771	1,981	7,147	7,275	16,403
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,143	△ 22,628	△ 4,128	△ 28,899	△ 29,207	△ 58,106	△ 4,423	△ 6,373	△ 4,339	△ 15,135
現金及び現金同等物の期首残高	92,619	87,775	69,333	92,619	60,722	92,619	44,755	42,766	43,806	44,755
現金及び現金同等物の四半期末残高	87,775	69,333	60,722	60,722	44,755	44,755	42,766	43,806	47,728	47,728

# 研究開発費／設備投資／減価償却費(5月13日公表)

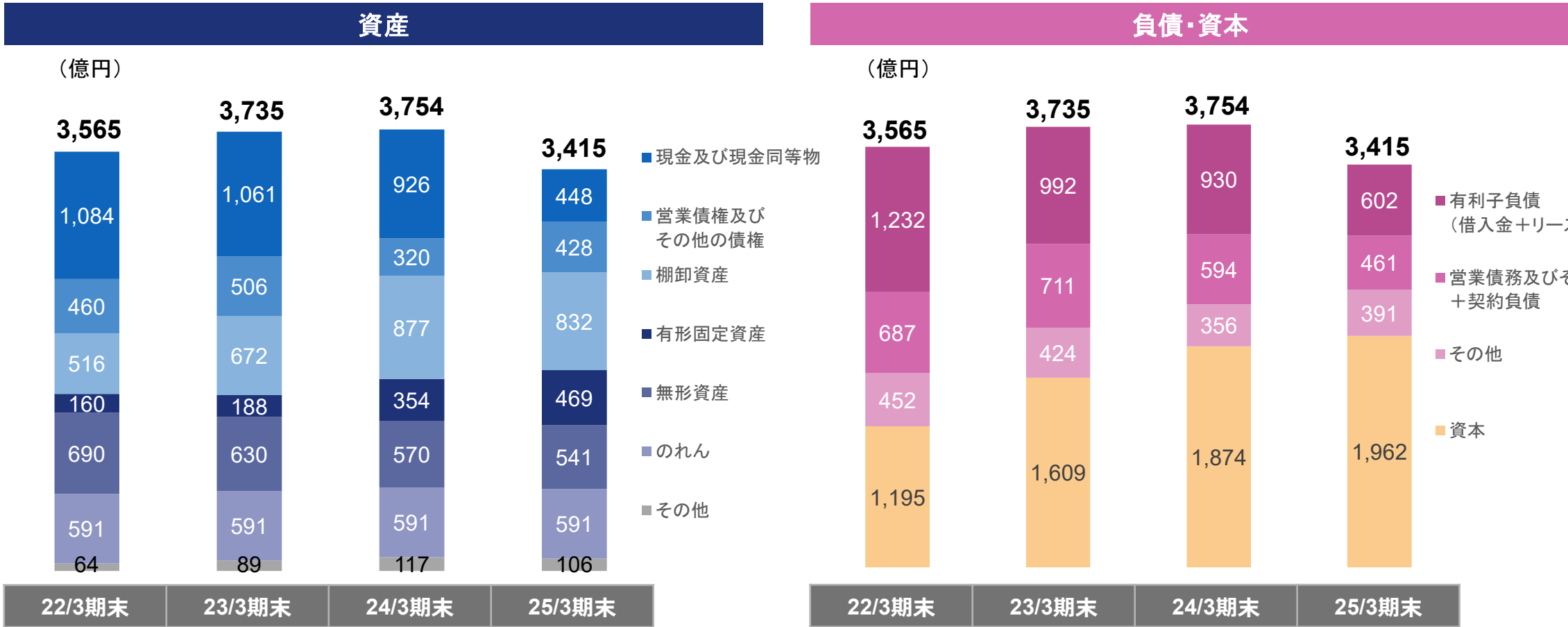
中長期的な需要拡大を見据え、中計に沿って研究開発投資、設備投資を実施。  
研究開発費は前期比2割増。設備投資は2年続いた大型設備投資が完了、減価償却費は前期比2割増。





# 貸借対照表(5月13日公表)

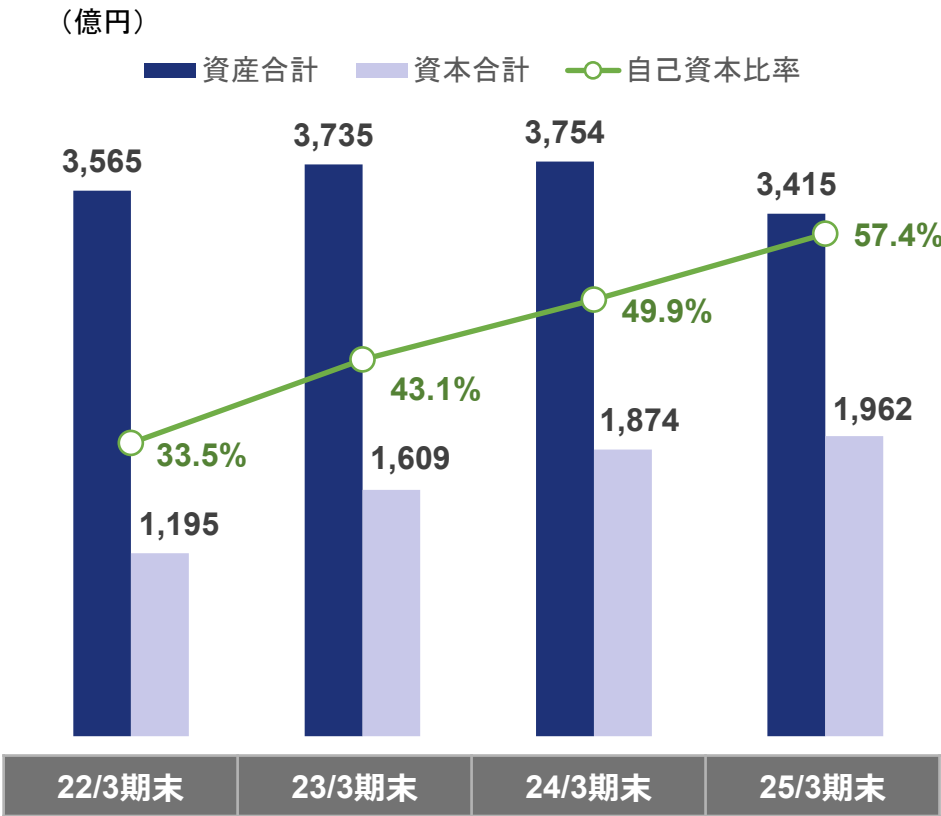
資産合計は、借入金の期限前返済、自己株式の取得による現金等の減少により、前期末比で339億円減少。  
負債合計は、借入金の返済、営業債務等の減少により、前期末比で427億円減少。資本合計は利益剰余金の増加等により、前期末比で88億円増加。



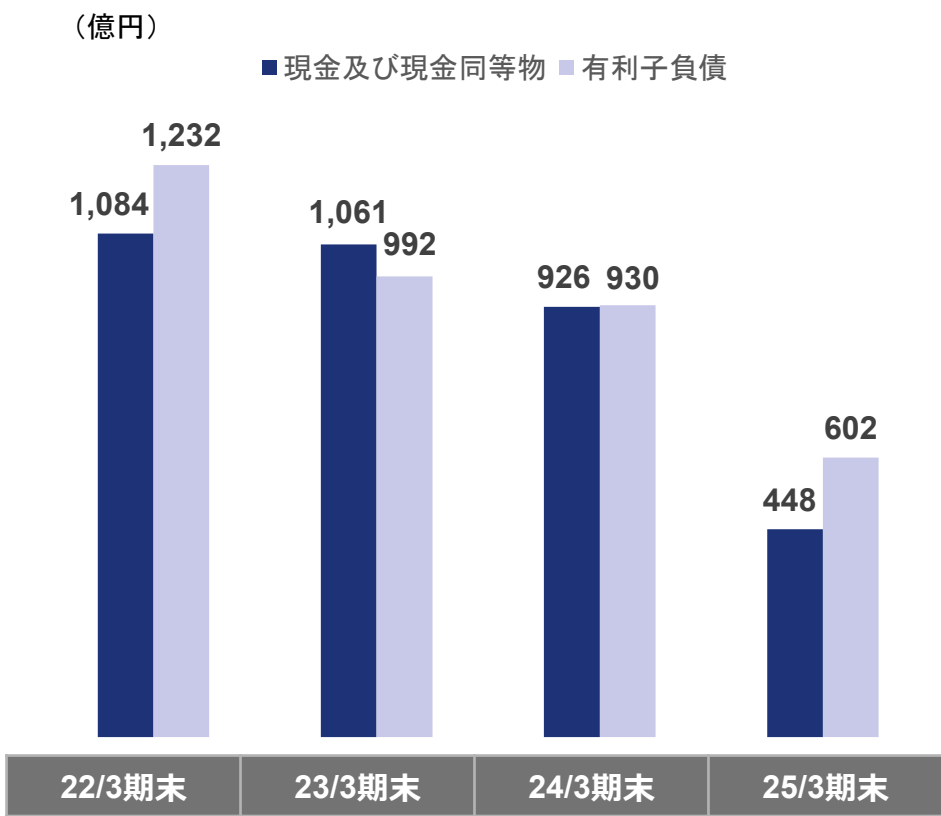
# 自己資本比率 & 現金及び現金同等物／有利子負債(5月13日公表)

当期末の自己資本比率は57%に上昇。当期末のネットデットは自己株式の取得による現金の支出等で154億円に増加したものの、借入金は期限前返済により333億円減少。

資産合計／資本合計／自己資本比率

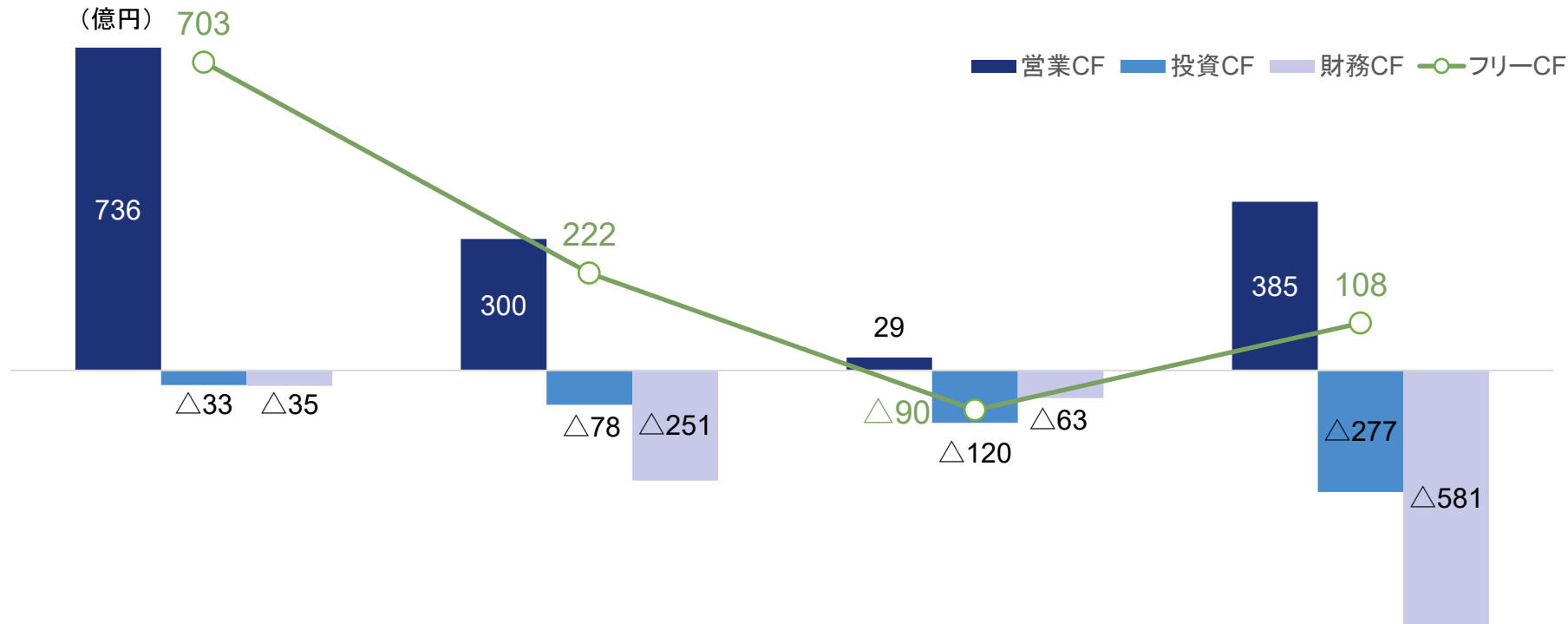


現金及び現金同等物／有利子負債



# キャッシュ・フロー(5月13日公表)

売上収益増加による営業CFが有形固定資産取得による投資CFの支出を上回り、フリーCFは108億円。  
財務CFは借入金の期限前返済と自己株式の取得による支出等により、581億円の支出。

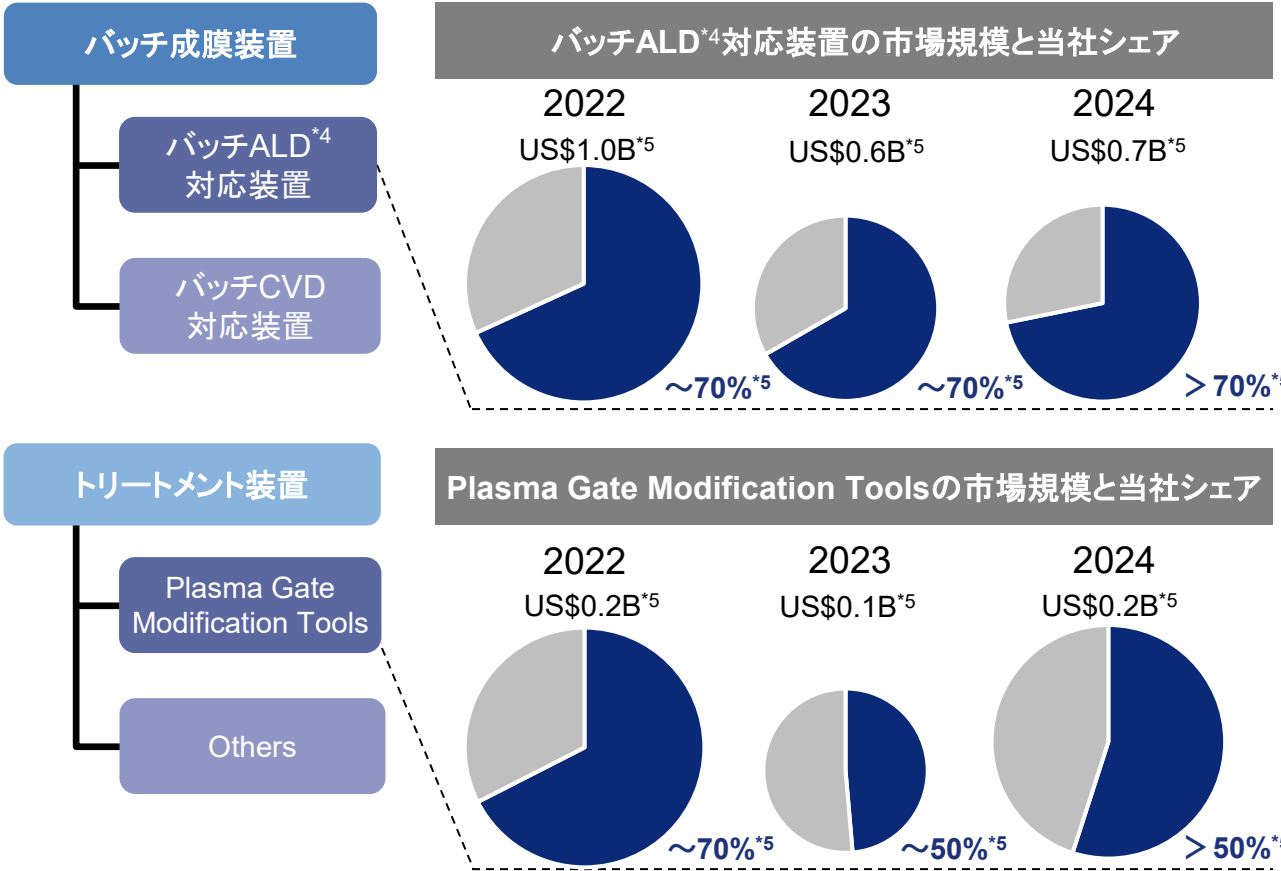
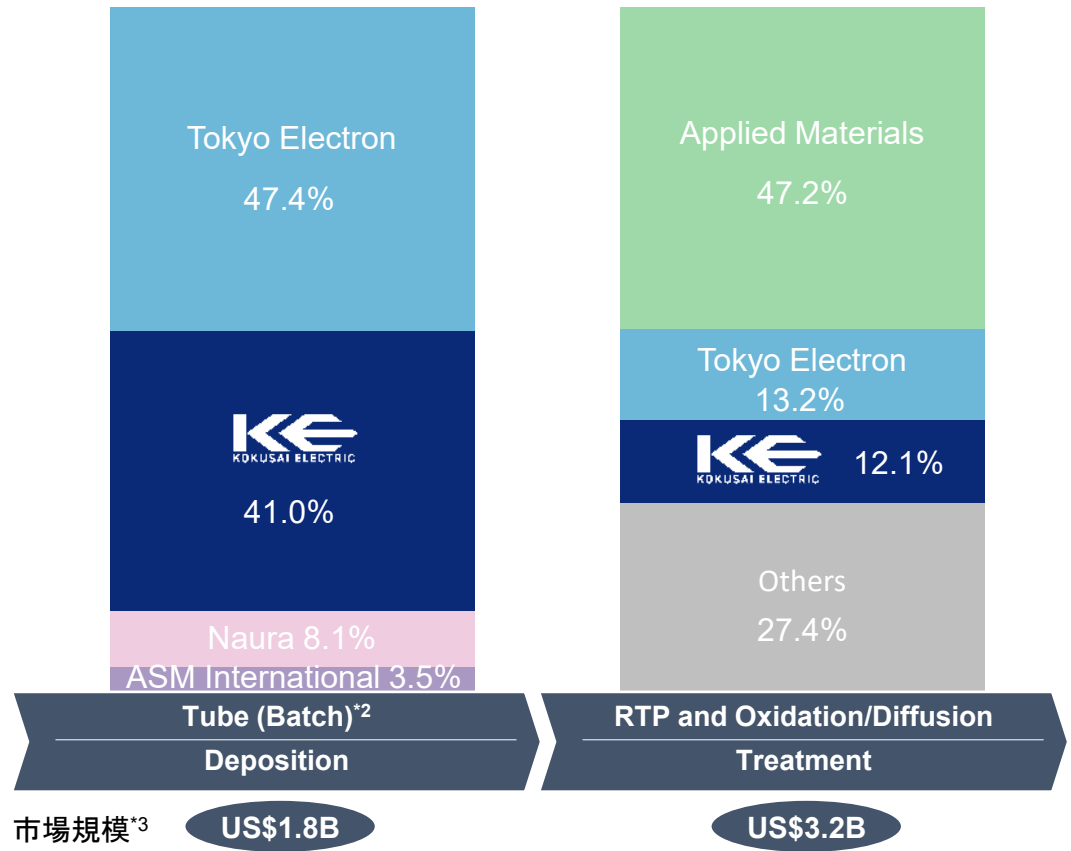


(億円)	22/3期	23/3期	24/3期	25/3期
営業CF	736	300	29	385
投資CF	△33	△78	△120	△277
財務CF	△35	△251	△63	△581
フリーCF	703	222	△90	108
現金及び現金同等物残高	1,084	1,061	926	448

# マーケットシェアの推移(5月13日公表)

CY24は、CY23比でバッチ成膜装置、枚葉トリートメント装置ともシェア回復。  
バッチALD<sup>\*4</sup>対応装置シェアは70%超で過去最高、枚葉トリートメント装置シェアは50%超に上昇。

(CY24) Gartnerの分類に基づく市場シェア<sup>\*1</sup>



<sup>\*1</sup> 出典: Gartner®, Market Share: Semiconductor Wafer Fab Equipment, Worldwide, 2024, Bob Johnson et al. Published 21 April 2025 図はガートナーリサーチに基づき、Kokusai Electricが作成。ここに記載のある数値は、Kokusai Electricにより算出されたものです。Treatment(トリートメント装置): RTP and Oxidation/Diffusion。  
GARTNERは、Gartner Inc.または関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークであり、同社の許可に基づいて使用しています。All rights reserved. Gartnerは、Gartnerリサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するようにテクノロジーユーザーに助言するものではありません。Gartnerリサーチの発行物は、Gartnerリサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。Gartnerは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の責任を負うものではありません。本書に記載するGartnerのコンテンツ(以下「Gartnerコンテンツ」)は、Gartnerシンジケート・サブスクリプション・サービスの一部としてGartner, Inc.(以下「Gartner」)が発行したリサーチ・オピニオンまたは見解を表すものであり、事実を述べているものではありません。Gartnerコンテンツの内容はいずれも、そのコンテンツが発行された当時の内容であり、本書が発行された日の内容ではありません。また、Gartnerコンテンツに記載されている見解は予告なく変更されることがあります。<sup>\*2</sup> GartnerによるWFEセグメントにおける「Tube CVD」を「Tube (Batch)」と定義(当社にて算出) <sup>\*3</sup> Gartnerによるカテゴリーの合計値 <sup>\*4</sup> 当社グループでは、複数のガスをサイクリックに供給する工程を伴い、原子層レベルで成膜する手法を「ALD」と呼んでいます <sup>\*5</sup> 公開情報・当社売上高に基づき当社推定

# 2026年3月期第2四半期までの主な活動報告 経営・事業活動

## 経営・事業活動

- ASMPと半導体パッケージ技術に関する共同開発契約を締結。(25/9)
- ロームから2025年度「優秀サプライヤー賞」を受賞。(25/9)
- 「SEMICON® Taiwan 2025」に出展。(25/9)
- 「SSDM2025」で当社従業員が口頭発表。(25/9)
- 横浜国立大学との共同研究により次世代3D半導体デバイスの省エネルギー化に貢献する新規膜とその接合プロセスを実証。(25/6)
- 「SEMICON® Southeast Asia 2025」に出展。(25/5)
- 「MEMS Engineer FORUM 2025」に出展。(25/4)



「SEMICON® Taiwan 2025」当社グループの展示ブース



「FAB EQUIPMENT」「WFE TO SPECIALTY CHIP MAKERS」の  
両部門において、トップ10にランクイン

# 2026年3月期第2四半期(累計)の主な活動報告 ESGの取り組み

## ESGの取り組み

- 富山市八尾町で開催された「おわら風の盆」に協賛。(25/9)
- CDP2024「サプライヤー・エンゲージメント評価」で最高評価を獲得。(25/7)
- 「FTSE Blossom Japan Sector Relative Index」の構成銘柄に選定。(25/6)
- TechInsightsの顧客満足度調査「Global Semiconductor Supplier Awards」で「Top 10 Customer Service」を28年連続で受賞。(25/5)
- 保育所施設で青空環境教室を実施。(25/5)
- 100%再生可能エネルギーの使用をめざす国際イニシアティブ「RE100」に参画。(25/4)
- 富山事業所で「とやま水の郷でんき」の使用量を全体の35%に引き上げ。(25/4)
- 富山県砺波市で開催される「2025となみチューリップフェア」に協賛。(25/4)
- 富山マラソン2025にゴールドパートナーとしての協賛を決定。(25/4)



CDP2024で  
サプライヤー・エンゲージメント・リーダーに選定



富山マラソン2025に  
ゴールドパートナーとして協賛

# 用語集

- バッチ処理装置：多数のウェーハを一括処理する装置
- 枚葉トリートメント装置：ウェーハを1枚単位で処理する枚葉方式により成膜後の膜質を改善する装置
- ALD: Atomic Layer Depositionの略  
当社グループでは、複数のガスをサイクリックに供給する工程を伴い、原子層レベルで成膜する手法を「ALD」と呼んでいます。
- CVD: Chemical Vapor Depositionの略
- CFET: Complimentary Field Effect Transistorの略
- FinFET: Fin Field Effect Transistorの略
- GAA: Gate All Aroundの略
- HBM: High Bandwidth Memoryの略
- POR : Process of Recordの略で、顧客の半導体製造プロセスにおける製造装置認定を指す。
- TAM: Total Addressable Marketの略
- VCT: Vertical Channel Transistorの略
- WFE: Wafer Fab Equipmentの略

